АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"

**111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д.55, к.31
тел.: (495) 989-86-70
факс: (495) 988-26-92**

Филиал: 428024, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 90/1, тел.: (8352) 28-64-77, факс: (8352) 28-63-55, e-mail: mail@energomodul.ru, energomodul@list.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

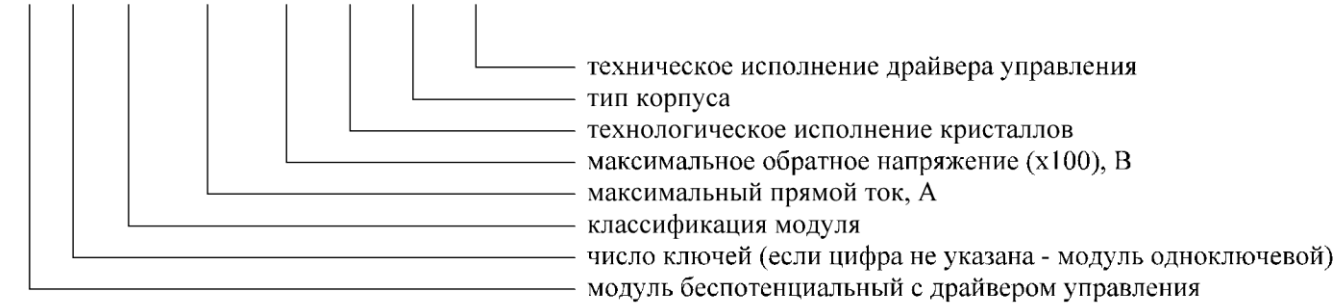
Силовые модули
со встроенным драйвером управления
SiC MOSFET на кристаллах карбид кремния
второго поколения (Gen 2)
(1200 В)

2022 год

Силовые SiC MOSFET модули на кристаллах второго поколения (Gen 2) со встроенным драйвером управления предназначены для коммутации мощных нагрузок в различных видах преобразователей, инверторах и электроприводах.

Условное обозначение:

МС Х ХХХ - ХХХ - ХХ - ХХ - ХХ - ХХ



Разновидности модулей:

1. **МСТКПК** – одиночный ключ;
2. **МСПТКПК** – одиночный ключ переменного тока;
3. **МСДТКПК** – одиночный ключ нижнего уровня;
4. **МСТКПДК** – одиночный ключ верхнего уровня;
5. **МСДТКПДК** – одиночный ключ верхнего и нижнего уровня;
6. **МС2ТКПК** – двухключевой;
7. **МС2ТКППК** – двухключевой с общим эмиттером;
8. **МС4ТКПК** – четырехключевой;
9. **МС4ТКПКМ** – четырехключевой многоуровневый;
10. **МС4ТКПКТМ** – четырехключевой Т-мост (3L-мост);
11. **МС6ТКПК** – шестиключевой;
12. **МС4Д4ТКПК** – четырехключевой с диодным мостом;
13. **МС4ДР4ТКПК** – четырехключевой с раздельным диодным мостом;
14. **МС4Д6ТКПК** – шестиключевой с диодным мостом;
15. **МС4ДР6ТКПК** – шестиключевой с раздельным диодным мостом;
16. **МС6Д4ТКПК** – четырехключевой с трехфазным диодным мостом;
17. **МС6ДР4ТКПК** – четырехключевой с раздельным трехфазным диодным мостом;
18. **МС6Д6ТКПК** – шестиключевой с трехфазным диодным мостом;
19. **МС6ДР6ТКПК** – шестиключевой с раздельным трехфазным диодным мостом;

[1] Серия МСТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

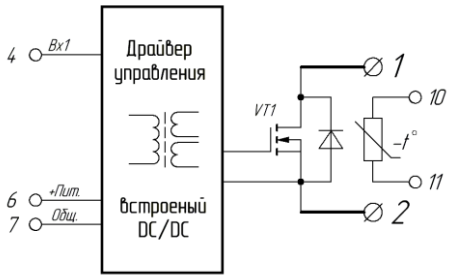


Рис 1.1
Серия МСТКПК
корпус П1

Модуль силовой
одиночный ключ
с драйвером управления

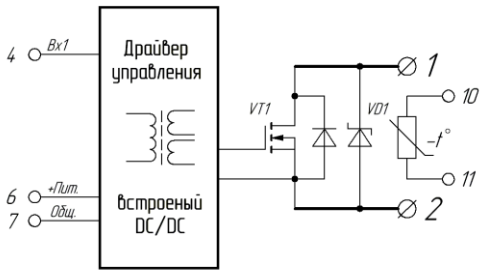


Рис 1.2
Серия МСТКПКШ
корпус П1

Модуль силовой
одиночный ключ с параллельным
диодом Шоттки и драйвером управления

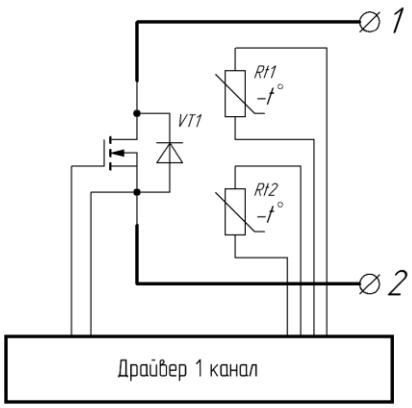


Рис 1.3
Серия МСТКПК
корпус П6

Модуль силовой
одиночный ключ
с драйвером управления
и контролем температуры

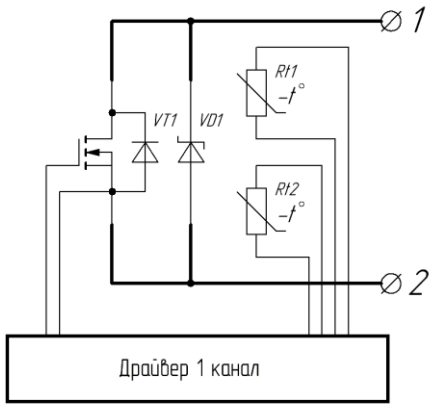


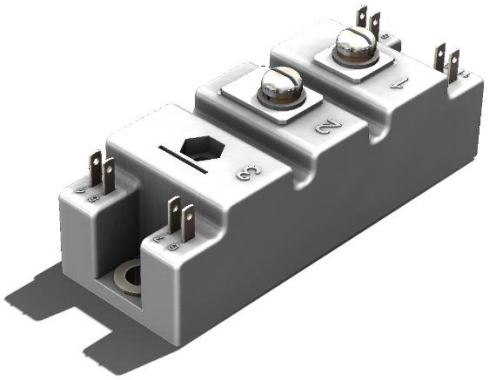
Рис 1.4
Серия МСТКПКШ
корпус П6

Модуль силовой
одиночный ключ с параллельным
диодом Шоттки, драйвером управления
и контролем температуры

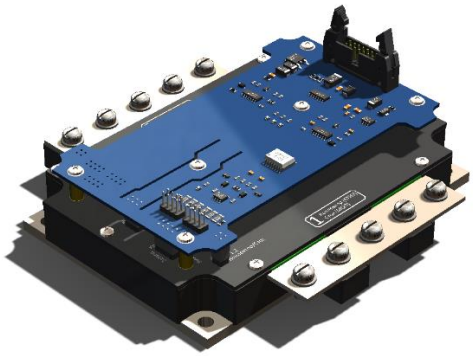
[1] Серия МСТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор МОП (MOSFET) SiC			Диод Шоттки SiC	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МСТКПК (Ш) одиночный ключ (диод Шоттки) с драйвером управления							
корпус П1							
МСТКПК-100-12-К1-П1-А МСТКПК-100-12-К1-П1-Б	1200	100	18	–	12 15	1.1	П1
МСТКПКШ-100-12-К1-П1-А МСТКПКШ-100-12-К1-П1-Б	1200	100	18	100	12 15	1.2	П1
МСТКПК-200-12-К1-П1-А МСТКПК-200-12-К1-П1-Б	1200	200	9,0	–	12 15	1.1	П1
МСТКПКШ-200-12-К1-П1-А МСТКПКШ-200-12-К1-П1-Б	1200	200	9,0	200	12 15	1.2	П1
МСТКПК-300-12-К1-П1-А МСТКПК-300-12-К1-П1-Б	1200	300/200	6,0	–	12 15	1.1	П1
МСТКПКШ-300-12-К1-П1-А МСТКПКШ-300-12-К1-П1-Б	1200	300/200	6,0	300/200	12 15	1.2	П1
корпус П6							
МСТКПК-600-12-К1-П6-А1 МСТКПК-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	–	12 15	1.3	П6
МСТКПКШ-600-12-К1-П6-А1 МСТКПКШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	1.4	П6
МСТКПК-800-12-К1-П6-А1 МСТКПК-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	–	12 15	1.3	П6
МСТКПКШ-800-12-К1-П6-А1 МСТКПКШ-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	800	12 15	1.4	П6
МСТКПК-1000-12-К1-П6-А1 МСТКПК-1000-12-К1-П6-Б1	1200	1000	1,8	–	12 15	1.3	П6
МСТКПКШ-1000-12-К1-П6-А1 МСТКПКШ-1000-12-К1-П6-Б1	1200	1000	1,8	1000	12 15	1.4	П6
МСТКПК-1200-12-К1-П6-А1 МСТКПК-1200-12-К1-П6-Б1	1200	1200	1,5	–	12 15	1.3	П6
МСТКПКШ-1200-12-К1-П6-А1 МСТКПКШ-1200-12-К1-П6-Б1	1200	1200	1,5	1200	12 15	1.4	П6
МСТКПК-1400-12-К1-П6-А1 МСТКПК-1400-12-К1-П6-Б1	1200	1400/1200	1,3	–	12 15	1.3	П6
МСТКПКШ-1400-12-К1-П6-А1 МСТКПКШ-1400-12-К1-П6-Б1	1200	1400/1200	1,3	1400/1200	12 15	1.4	П6
МСТКПК-1600-12-К1-П6-А1 МСТКПК-1600-12-К1-П6-Б1	1200	1600/1200	1,2	–	12 15	1.3	П6
МСТКПКШ-1600-12-К1-П6-А1 МСТКПКШ-1600-12-К1-П6-Б1	1200	1600/1200	1,2	1600/1200	12 15	1.4	П6

[1] Серия МСТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П1**
габаритные размеры:
94x34x30 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[2] Серия МСПТКПК, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

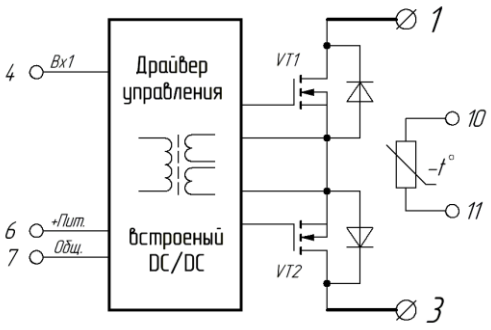


Рис 2.1
Серия МСПТКПК
корпус П1

Модуль силовой
одиночный ключ переменного тока
с драйвером управления

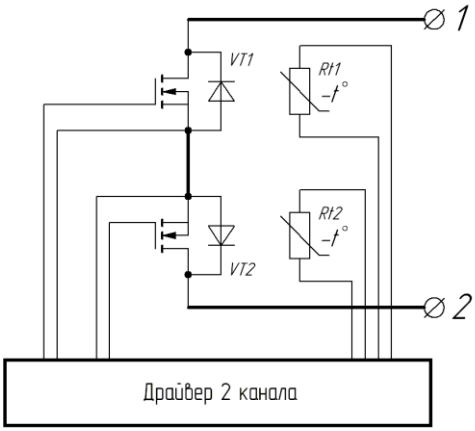


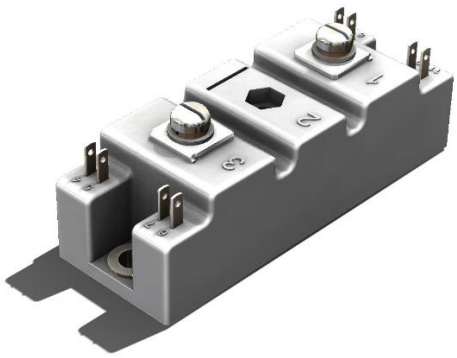
Рис 2.2
Серия МСПТКПК
корпус П6

Модуль силовой
одиночный ключ переменного тока
с драйвером управления
и контролем температуры

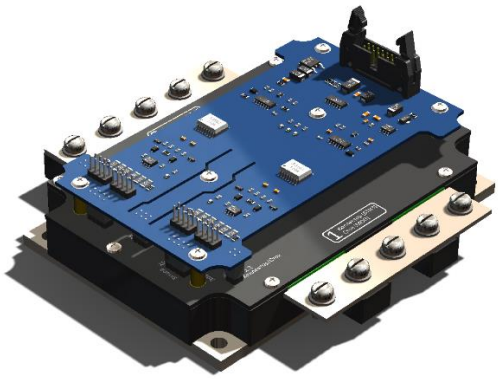
Серия МСПТКПК, модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МСПТКПК одиночный ключ переменного тока (твердотельное реле) с драйвером управления							
корпус П1							
МСПТКПК-100-12-К1-П1-А МСПТКПК-100-12-К1-П1-Б	1200	100	36 (общее)	–	12 15	2.1	П1
МСПТКПК-200-12-К1-П1-А МСПТКПК-200-12-К1-П1-Б	1200	200	18 (общее)	–	12 15	2.1	П1
МСПТКПК-300-12-К1-П1-А МСПТКПК-300-12-К1-П1-Б	1200	300/200	12 (общее)	–	12 15	2.1	П1
МСПТКПК-400-12-К1-П1-А МСПТКПК-400-12-К1-П1-Б	1200	400/200	9,0 (общее)	–	12 15	2.1	П1
корпус П6							
МСПТКПК-600-12-К1-П6-А1 МСПТКПК-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	6,0 (общее)	–	12 15	2.2	П6
МСПТКПК-800-12-К1-П6-А1 МСПТКПК-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	4,5 (общее)	–	12 15	2.2	П6
МСПТКПК-1000-12-К1-П6-А1 МСПТКПК-1000-12-К1-П6-Б1	1200	1000	3,6 (общее)	–	12 15	2.2	П6
МСПТКПК-1200-12-К1-П6-А1 МСПТКПК-1200-12-К1-П6-Б1	1200	1200	3,0 (общее)	–	12 15	2.2	П6

[2] Серия МСПТКПК, модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П1**
габаритные размеры:
94x34x30 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[3] Серия МСДТКПКШ, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

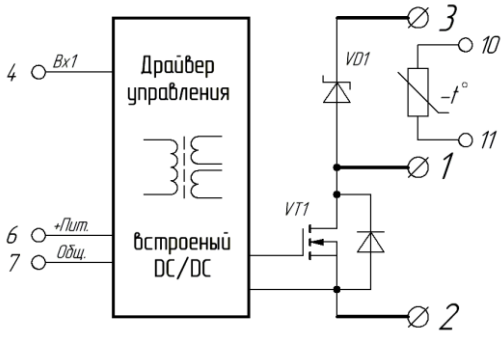


Рис 3.1
Серия МСДТКПКШ
корпус П1

Модуль силовой
одиночный ключ нижнего уровня
с последовательным диодом Шоттки и
драйвером управления

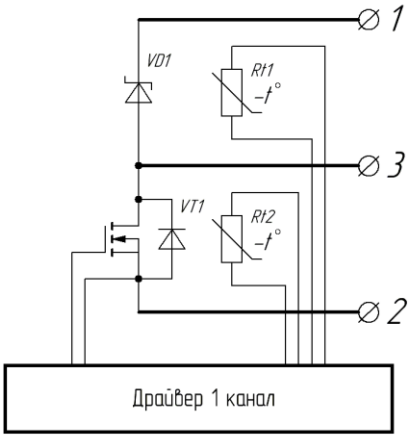


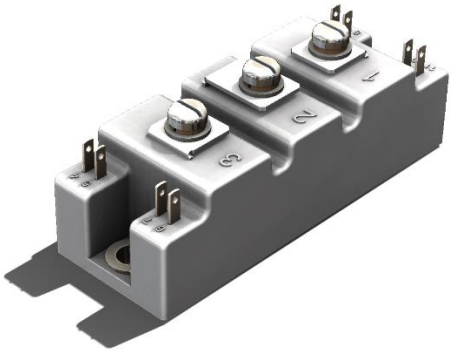
Рис 3.2
Серия МСДТКПКШ
корпус П6

Модуль силовой
одиночный ключ нижнего уровня
с последовательным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

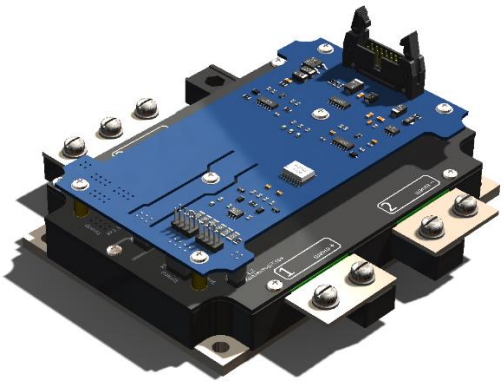
Серия МСДТКПКШ модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МСДТКПКШ одиночный ключ нижнего уровня с диодом Шоттки и драйвером управления							
корпус П1							
МСДТКПКШ-100-12-К1-П1-А МСДТКПКШ-100-12-К1-П1-Б	1200	100	18	100	12 15	3.1	П1
МСДТКПКШ-200-12-К1-П1-А МСДТКПКШ-200-12-К1-П1-Б	1200	200	9,0	200	12 15	3.1	П1
корпус П6							
МСДТКПКШ-400-12-К1-П6-А1 МСДТКПКШ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	3.2	П6
МСДТКПКШ-600-12-К1-П6-А1 МСДТКПКШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	3.2	П6
МСДТКПКШ-800-12-К1-П6-А1 МСДТКПКШ-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	800	12 15	3.2	П6

[3] Серия МСДТКПКШ, модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П1**
габаритные размеры:
94x34x30 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[4] Серия МСТКПДКШ, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

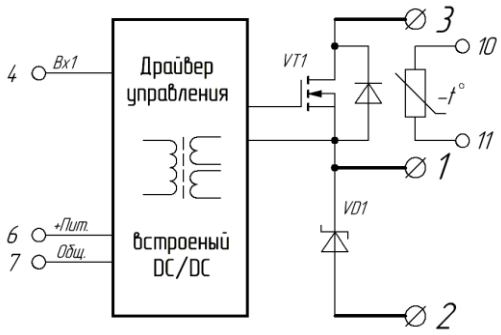


Рис 4.1
Серия МСТКПДКШ
корпус П1

Модуль силовой
одиночный ключ верхнего уровня
с последовательным диодом Шоттки
и драйвером управления

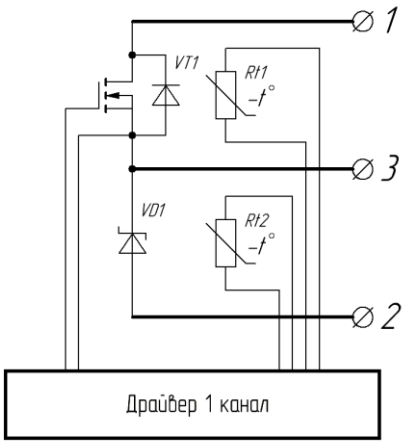


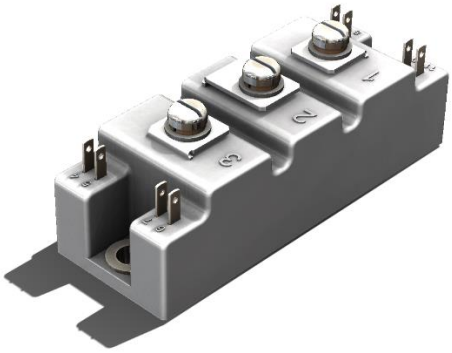
Рис 4.2
Серия МСТКПДКШ
корпус П6

Модуль силовой
одиночный ключ верхнего уровня
с последовательным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

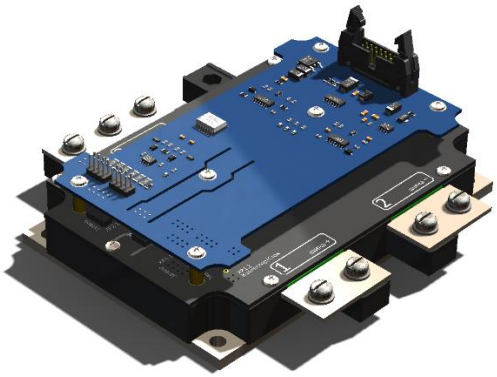
Серия МСТКПДКШ модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МСТКПДКШ одиночный ключ верхнего уровня с диодом Шоттки и драйвером управления							
корпус П1							
МСТКПДКШ-100-12-К1-П1-А МСТКПДКШ-100-12-К1-П1-Б	1200	100	18	100	12 15	4.1	П1
МСТКПДКШ-200-12-К1-П1-А МСТКПДКШ-200-12-К1-П1-Б	1200	200	9,0	200	12 15	4.1	П1
корпус П6							
МСТКПДКШ-400-12-К1-П6-А1 МСТКПДКШ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	4.2	П6
МСТКПДКШ-600-12-К1-П6-А1 МСТКПДКШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	4.2	П6
МСТКПДКШ-800-12-К1-П6-А1 МСТКПДКШ-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	800	12 15	4.2	П6

[4] Серия МСТКПДКШ, модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П1**
габаритные размеры:
94x34x30 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[5] Серия МСДТКПДКШ, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

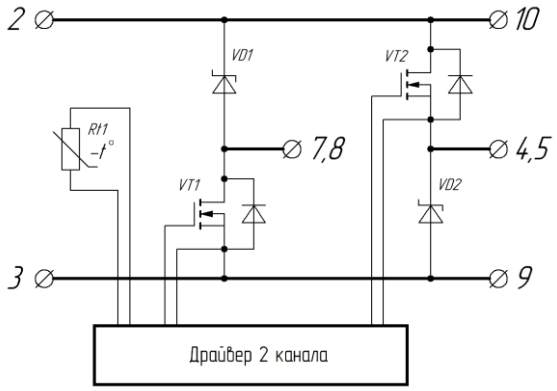


Рис 5.1
Серия МСДТКПДКШ
корпус П5

Модуль силовой
одиночный ключ верхнего и нижнего уровня
с последовательным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

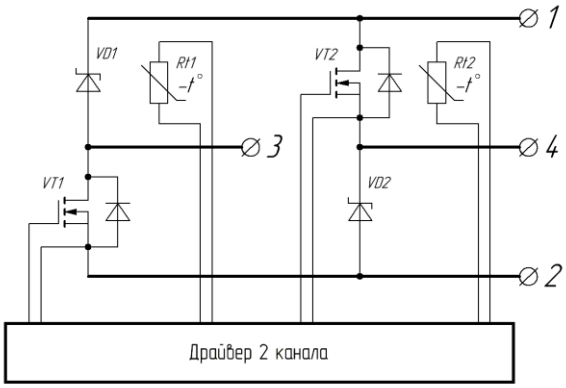


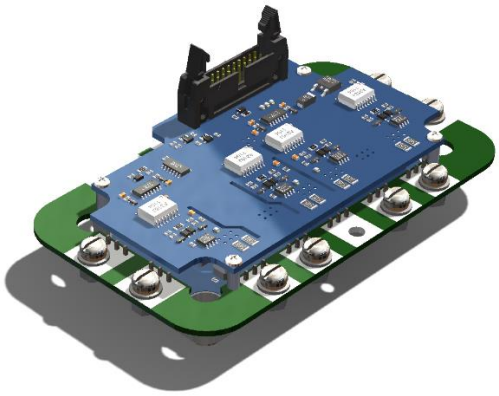
Рис 5.2
Серия МСДТКПДКШ
корпус П6

Модуль силовой
одиночный ключ верхнего и нижнего уровня
с последовательным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

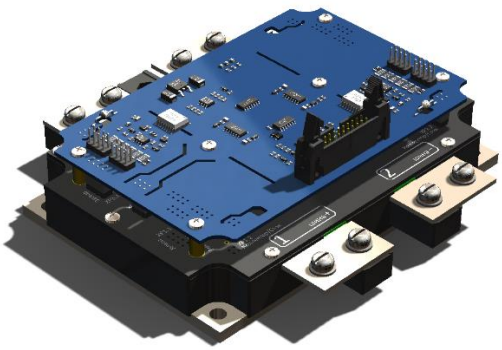
[5] Серия МСДТКПДКШ, модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор МОП (MOSFET) SiC			Диод Шоттки SiC	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МСДТКПДКШ одиночный ключ верхнего и нижнего уровня с диодом Шоттки и драйвером упр.							
корпус П5							
МСДТКПДКШ-100-12-К1-П1-А МСДТКПДКШ-100-12-К1-П1-Б	1200	100	18	100	12 15	4.1	П5
МСДТКПДКШ-200-12-К1-П1-А МСДТКПДКШ-200-12-К1-П1-Б	1200	200	9,0	200	12 15	4.1	П5
МСДТКПДКШ-300-12-К1-П1-А МСДТКПДКШ-300-12-К1-П1-Б	1200	300/200	6,0	300/200	12 15	4.1	П5
корпус П6							
МСДТКПДКШ-300-12-К1-П6-А1 МСДТКПДКШ-300-12-К1-П6-Б1	1200	300	6,0	300	12 15	4.2	П6
МСДТКПДКШ-400-12-К1-П6-А1 МСДТКПДКШ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	4.2	П6
МСДТКПДКШ-500-12-К1-П6-А1 МСДТКПДКШ-500-12-К1-П6-Б1	1200	500	3,6	500	12 15	4.2	П6
МСДТКПДКШ-600-12-К1-П6-А1 МСДТКПДКШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	4.2	П6

Серия МСДТКПДКШ, модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162х156х64 мм

[6] Серия МС2ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

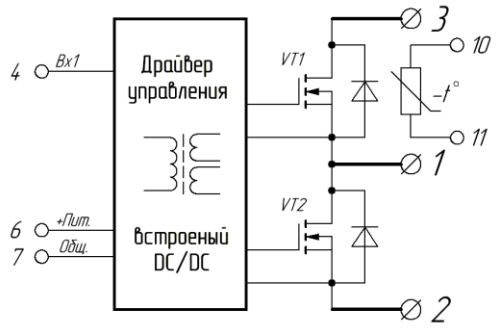


Рис 6.1
Серия МС2ТКПК
корпус П1, драйвер И

Модуль силовой двухключевой
с драйвером управления (инверсное управление)

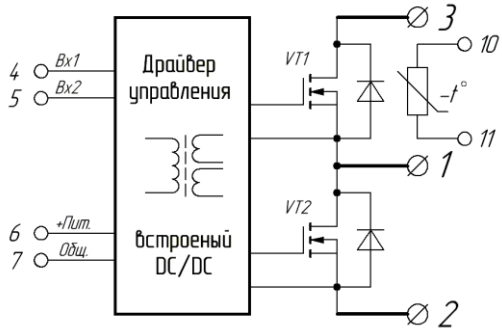


Рис 6.2
Серия МС2ТКПК
корпус П1, драйвер Р

Модуль силовой двухключевой
с драйвером управления (раздельное управление)

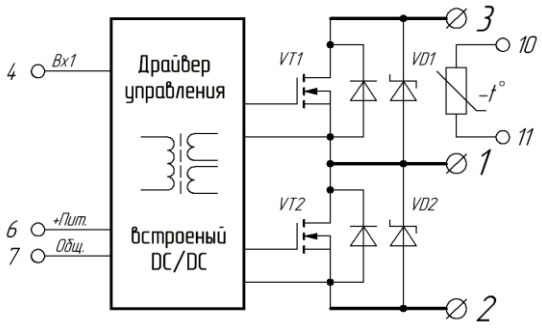


Рис 6.3
Серия МС2ТКПКШ
корпус П1, драйвер И

Модуль силовой двухключевой
с параллельным диодом Шоттки
и драйвером управления (инверсное управление)

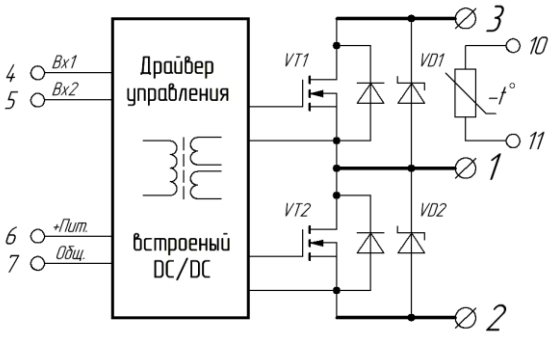


Рис 6.4
Серия МС2ТКПКШ
корпус П1, драйвер Р

Модуль силовой двухключевой
с параллельным диодом Шоттки
и драйвером управления (раздельное управление)

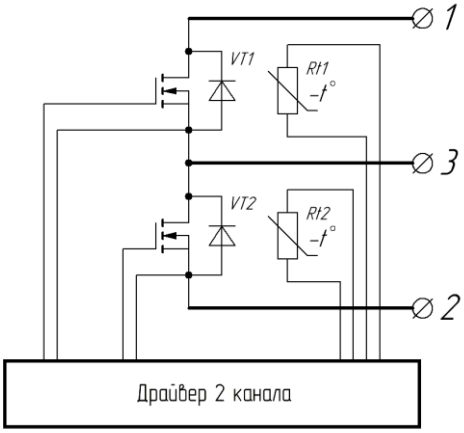


Рис 6.5
Серия МС2ТКПК
корпус П6

Модуль силовой двухключевой
с драйвером управления
и контролем температуры

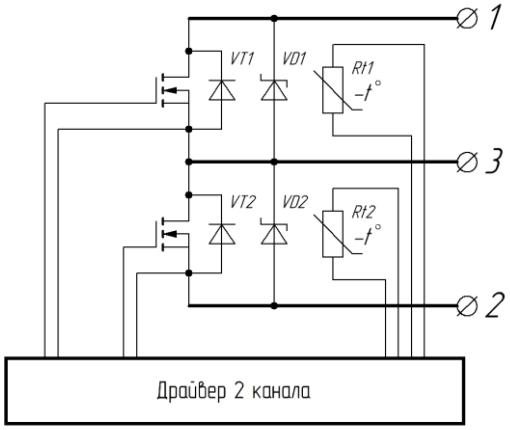


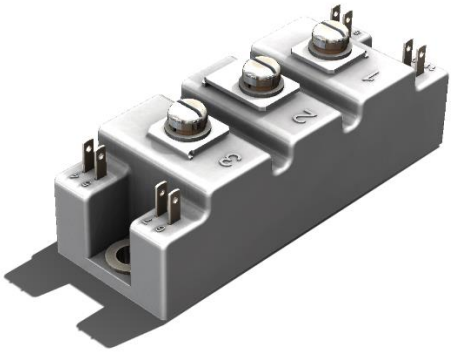
Рис 6.6
Серия МС2ТКПКШ
корпус П6

Модуль силовой двухключевой
с параллельным диодом Шоттки,
драйвером управления
и контролем температуры

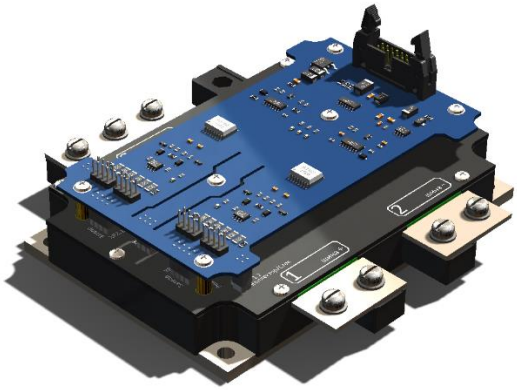
[6] Серия МС2ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС2ТКПК (Ш) двухключевой (диод Шоттки) с драйвером управления							
корпус П1							
МС2ТКПК-100-12-К1-П1-ИА МС2ТКПК-100-12-К1-П1-ИБ МС2ТКПК-100-12-К1-П1-РА МС2ТКПК-100-12-К1-П1-РБ	1200	100	18	–	12 15 12 15	6.1 6.2	П1
МС2ТКПКШ-100-12-К1-П1-ИА МС2ТКПКШ-100-12-К1-П1-ИБ МС2ТКПКШ-100-12-К1-П1-РА МС2ТКПКШ-100-12-К1-П1-РБ	1200	100	18	100	12 15 12 15	6.3 6.4	П1
МС2ТКПК-200-12-К1-П1-ИА МС2ТКПК-200-12-К1-П1-ИБ МС2ТКПК-200-12-К1-П1-РА МС2ТКПК-200-12-К1-П1-РБ	1200	200	9,0	–	12 15 12 15	6.1 6.2	П1
МС2ТКПКШ-200-12-К1-П1-ИА МС2ТКПКШ-200-12-К1-П1-ИБ МС2ТКПКШ-200-12-К1-П1-РА МС2ТКПКШ-200-12-К1-П1-РБ	1200	200	9,0	200	12 15 12 15	6.3 6.4	П1
МС2ТКПК-300-12-К1-П1-ИА МС2ТКПК-300-12-К1-П1-ИБ МС2ТКПК-300-12-К1-П1-РА МС2ТКПК-300-12-К1-П1-РБ	1200	300/200	6,0	–	12 15 12 15	6.1 6.2	П1
МС2ТКПКШ-300-12-К1-П1-ИА МС2ТКПКШ-300-12-К1-П1-ИБ МС2ТКПКШ-300-12-К1-П1-РА МС2ТКПКШ-300-12-К1-П1-РБ	1200	300/200	6,0	300/200	12 15 12 15	6.3 6.4	П1
корпус П6							
МС2ТКПК-600-12-К1-П6-А1 МС2ТКПК-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	–	12 15	6.5	П6
МС2ТКПКШ-600-12-К1-П6-А1 МС2ТКПКШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	6.6	П6
МС2ТКПК-800-12-К1-П6-А1 МС2ТКПК-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	–	12 15	6.5	П6
МС2ТКПКШ-800-12-К1-П6-А1 МС2ТКПКШ-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	800	12 15	6.6	П6
МС2ТКПК-1000-12-К1-П6-А1 МС2ТКПК-1000-12-К1-П6-Б1	1200	1000	1,8	–	12 15	6.5	П6
МС2ТКПКШ-1000-12-К1-П6-А1 МС2ТКПКШ-1000-12-К1-П6-Б1	1200	1000	1,8	1000	12 15	6.6	П6

[6] Серия МС2ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П1**
габаритные размеры:
94x34x30 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[7] Серия МС2ТКППК, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

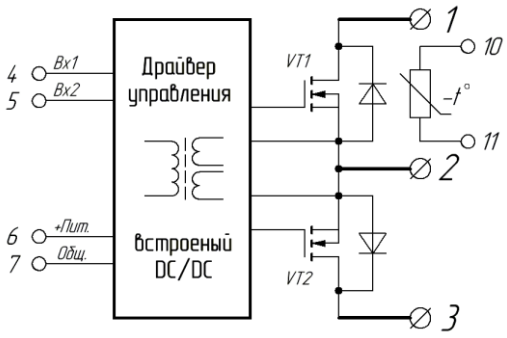


Рис 7.1
Серия МС2ТКППК
корпус П1

Модуль силовой
двухключевой (общий исток)
с драйвером управления

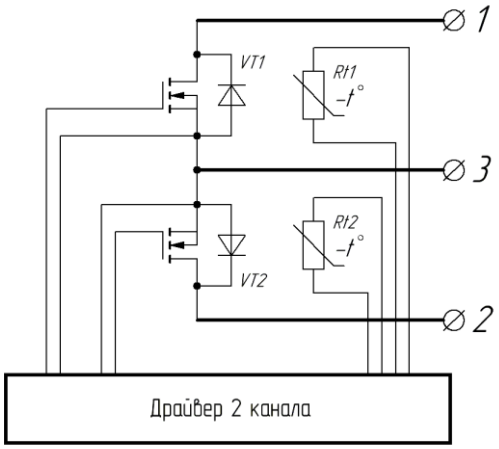


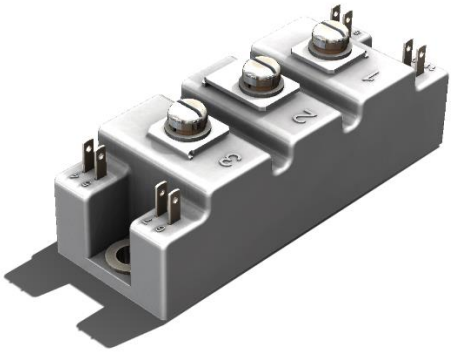
Рис 7.2
Серия МС2ТКППК
корпус П6

Модуль силовой
двухключевой (общий исток)
с драйвером управления
и контролем температуры

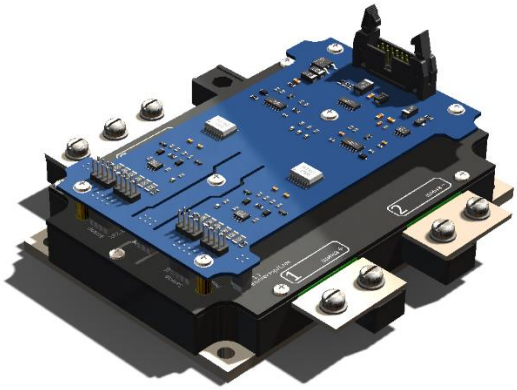
Серия МС2ТКППК, модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор МОП (MOSFET) SiC			Диод Шоттки SiC	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС2ТКППК двухключевой (общий исток) с драйвером управления							
корпус П1							
МС2ТКППК-100-12-К1-П1-А МС2ТКППК-100-12-К1-П1-Б	1200	100	18	–	12 15	7.1	П1
МС2ТКППК-200-12-К1-П1-А МС2ТКППК-200-12-К1-П1-Б	1200	200	9,0	–	12 15	7.1	П1
МС2ТКППК-300-12-К1-П1-А МС2ТКППК-300-12-К1-П1-Б	1200	300/200	6,0	–	12 15	7.1	П1
корпус П6							
МС2ТКППК-600-12-К1-П6-А1 МС2ТКППК-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	–	12 15	7.2	П6
МС2ТКППК-800-12-К1-П6-А1 МС2ТКППК-800-12-К1-П6-Б1	1200	800	2,3	–	12 15	7.2	П6
МС2ТКППК-1000-12-К1-П6-А1 МС2ТКППК-1000-12-К1-П6-Б1	1200	1000	1,8	–	12 15	7.2	П6

[7] Серия МС2ТКППК, модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П1**
габаритные размеры:
94x34x30 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[8] Серия МС4ТКПК, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

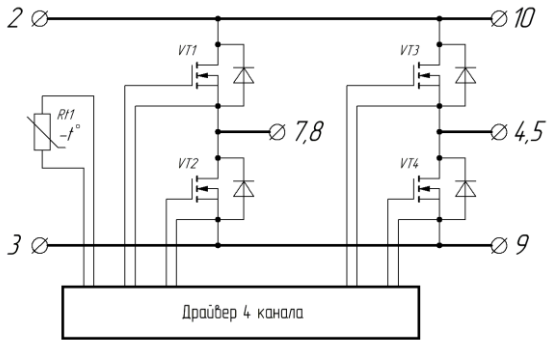


Рис 8.1
Серия МС4ТКПК
корпус П5

Модуль силовой
четырехключевой с драйвером управления
и контролем температуры

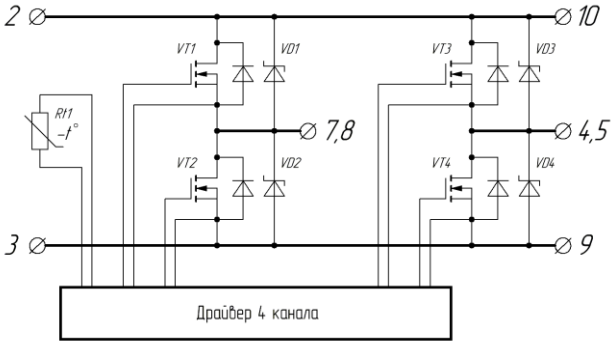


Рис 8.2
Серия МС4ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой
четырехключевой с параллельным
диодом Шоттки, драйвером управления
и контролем температуры

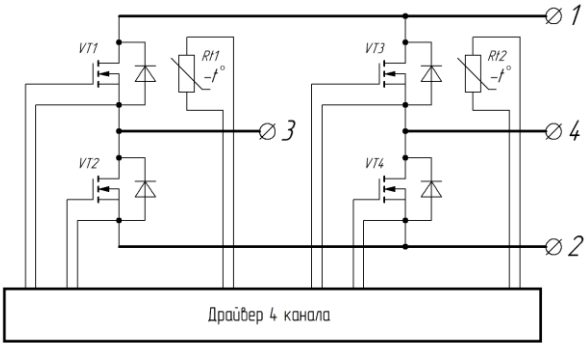


Рис 8.3
Серия МС4ТКПК
корпус П6

Модуль силовой четырехключевой с
драйвером управления и контролем температуры

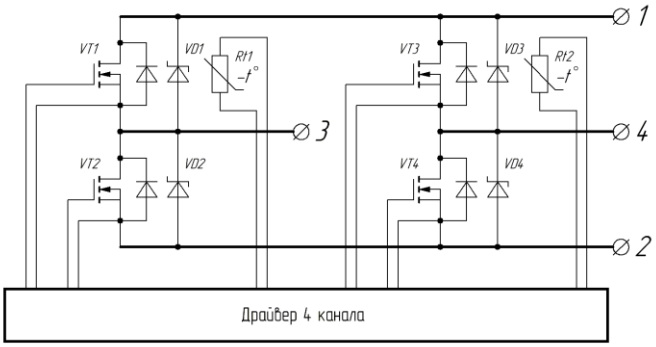


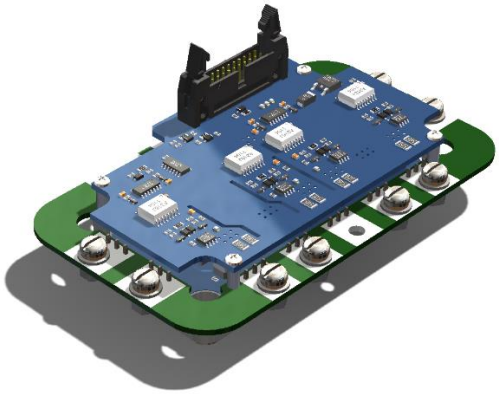
Рис 8.4
Серия МС4ТКПКШ
корпус П6

Модуль силовой четырехключевой с параллельным
диодом Шоттки, драйвером управления и контролем температуры

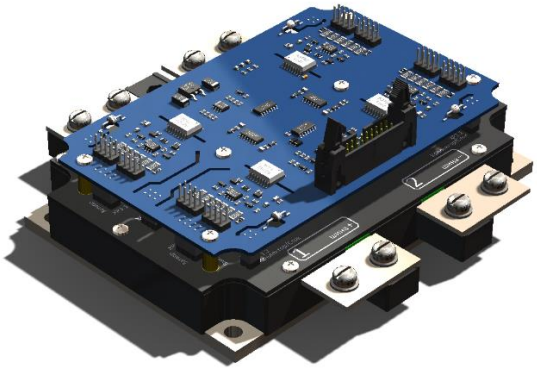
[8] Серия МС4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4ТКПК (Ш) четырехключевой (диод Шоттки) с драйвером управления							
корпус П5							
МС4ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС4ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	8.1	П5
МС4ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	8.2	П5
МС4ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС4ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200	9,0	–	12 15	8.1	П5
МС4ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200	9,0	200	12 15	8.2	П5
МС4ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС4ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/200	6,0	–	12 15	8.1	П5
МС4ТКПКШ-300-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКШ-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/200	6,0	300/200	12 15	8.2	П5
МС4ТКПК-400-12-К1-П5-А1 МС4ТКПК-400-12-К1-П5-Б1	1200	400/200	4,5	–	12 15	8.1	П5
МС4ТКПКШ-400-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКШ-400-12-К1-П5-Б1	1200	400/200	4,5	400/200	12 15	8.2	П5
корпус П6							
МС4ТКПК-300-12-К1-П6-А1 МС4ТКПК-300-12-К1-П6-Б1	1200	300	6,0	–	12 15	8.3	П6
МС4ТКПКШ-300-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКШ-300-12-К1-П6-Б1	1200	300	6,0	300	12 15	8.4	П6
МС4ТКПК-400-12-К1-П6-А1 МС4ТКПК-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	–	12 15	8.3	П6
МС4ТКПКШ-400-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКШ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	8.4	П6
МС4ТКПК-500-12-К1-П6-А1 МС4ТКПК-500-12-К1-П6-Б1	1200	500	3,6	–	12 15	8.3	П6
МС4ТКПКШ-500-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКШ-500-12-К1-П6-Б1	1200	500	3,6	500	12 15	8.4	П6
МС4ТКПК-600-12-К1-П6-А1 МС4ТКПК-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	–	12 15	8.3	П6
МС4ТКПКШ-600-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	8.4	П6

[8] Серия МС4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145x85x55 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[9] Серия МС4ТКПКМШ, модули SiC MOSFET схемы принципиальные

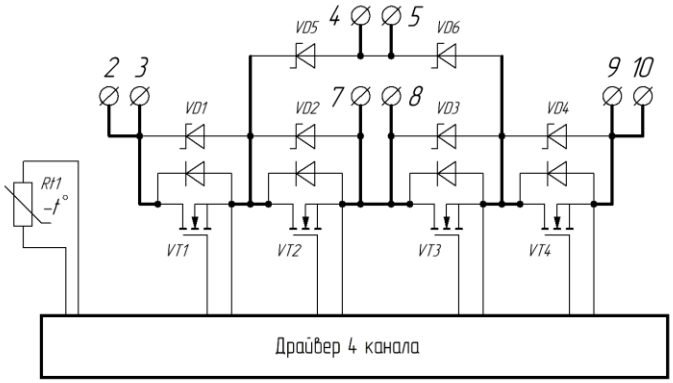


Рис 9.1
Серия МС4ТКПКМШ
корпус П5

Модуль силовой
четырехключевой многоуровневый с параллельным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

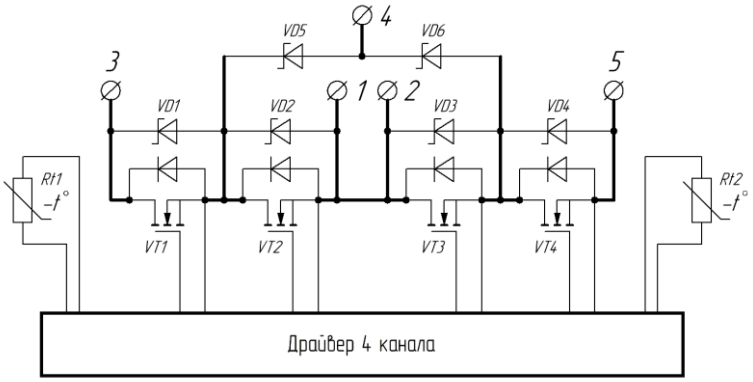


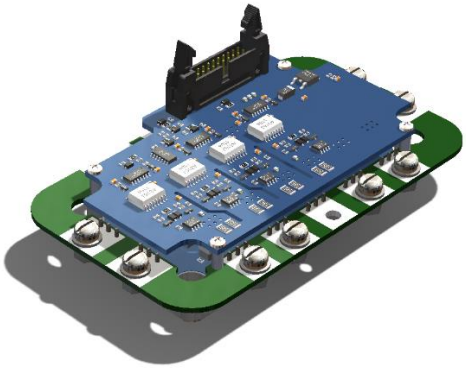
Рис 9.2
Серия МС4ТКПКМШ
корпус П6

Модуль силовой
четырехключевой многоуровневый с параллельным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

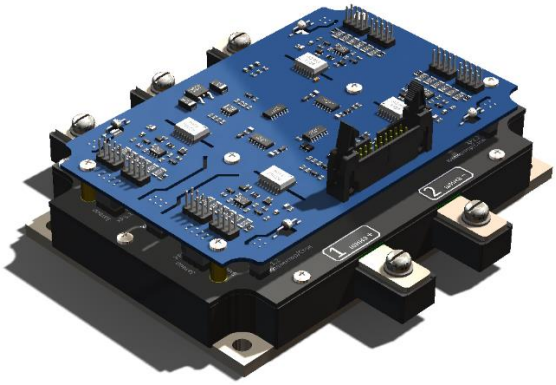
[9] Серия МС4ТКПКМШ, модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор МОП (MOSFET) SiC			Диод Шоттки SiC	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4ТКПКМШ четырехключевой многоуровневый с диодом Шоттки и драйвером управления							
корпус П5							
МС4ТКПКМШ-100-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКМШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	9.1	П5
МС4ТКПКМШ-200-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКМШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200	9,0	200	12 15	9.1	П5
корпус П6							
МС4ТКПКМШ-200-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКМШ-200-12-К1-П6-Б1	1200	200	9,0	200	12 15	9.2	П6
МС4ТКПКМШ-300-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКМШ-300-12-К1-П6-Б1	1200	300	6,0	300	12 15	9.2	П6
МС4ТКПКМШ-400-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКМШ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	9.2	П6

Серия МС4ТКПКМШ, модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162х156х64 мм

[10] Серия МС4ТКПКТМ (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

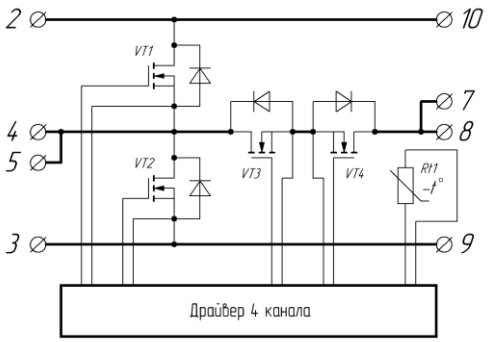


Рис 10.1
Серия МС4ТКПКТМ
корпус П5

Модуль силовой
четырехключевой Т-мост (3L-мост)
с драйвером управления
и контролем температуры

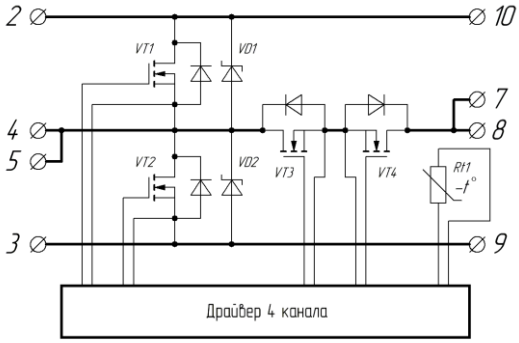


Рис 10.2
Серия МС4ТКПКТМШ
корпус П5

Модуль силовой
четырехключевой с параллельным
диодом Шоттки Т-мост (3L-мост),
драйвером управления
и контролем температуры

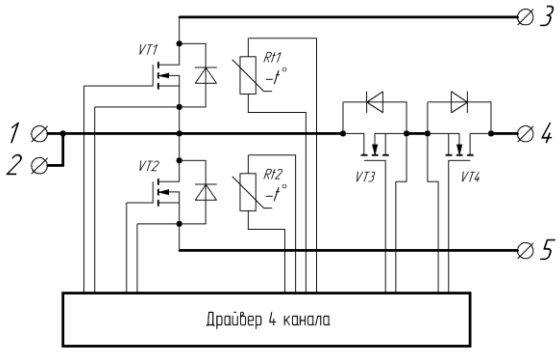


Рис 10.3
Серия МС4ТКПКТМ
корпус П6

Модуль силовой четырехключевой Т-мост (3L-мост)
с драйвером управления и контролем температуры

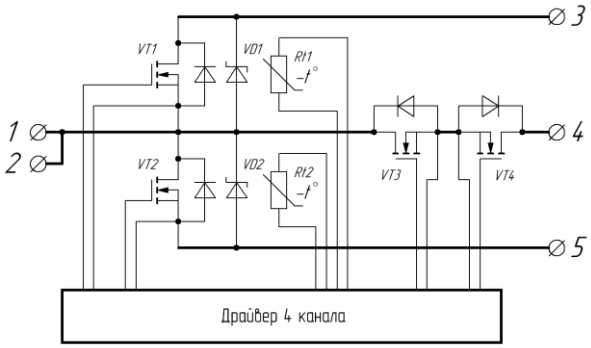


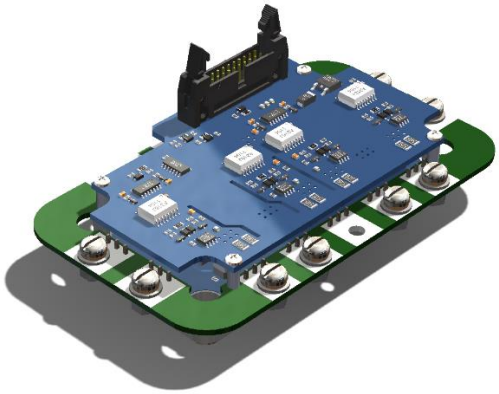
Рис 10.4
Серия МС4ТКПКТМШ
корпус П6

Модуль силовой четырехключевой с параллельным
диодом Шоттки Т-мост (3L-мост), драйвером управления
и контролем температуры

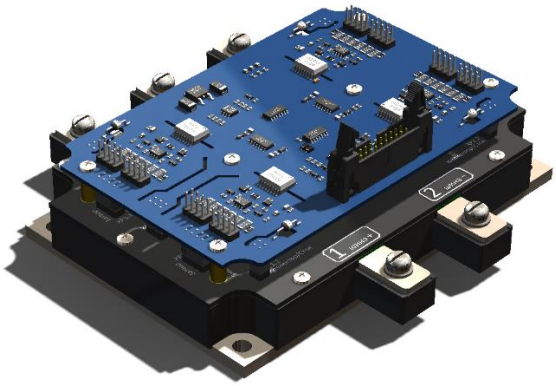
[10] Серия МС4ТКПКТМ (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор МОП (MOSFET) SiC			Диод Шоттки SiC	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4ТКПКТМ (Ш) четырехключевой Т-мост (3L-мост) с диодом Шоттки и драйвером управления							
корпус П5							
МС4ТКПКТМ-100-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКТМ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	10.1	П5
МС4ТКПКТМШ-100-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКТМШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	10.2	П5
МС4ТКПКТМ-200-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКТМ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200	9,0	–	12 15	10.1	П5
МС4ТКПКТМШ-200-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКТМШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200	9,0	200	12 15	10.2	П5
МС4ТКПКТМ-300-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКТМ-300-12-К1-П5-Б1	1200	300	6,0	–	12 15	10.1	П5
МС4ТКПКТМШ-300-12-К1-П5-А1 МС4ТКПКТМШ-300-12-К1-П5-Б1	1200	300	6,0	300	12 15	10.2	П5
корпус П6							
МС4ТКПКТМ-400-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКТМ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	–	12 15	10.3	П6
МС4ТКПКТМШ-400-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКТМШ-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	10.4	П6
МС4ТКПКТМ-500-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКТМ-500-12-К1-П6-Б1	1200	500	3,6	–	12 15	10.3	П6
МС4ТКПКТМШ-500-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКТМШ-500-12-К1-П6-Б1	1200	500	3,6	500	12 15	10.4	П6
МС4ТКПКТМ-600-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКТМ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	–	12 15	10.3	П6
МС4ТКПКТМШ-600-12-К1-П6-А1 МС4ТКПКТМШ-600-12-К1-П6-Б1	1200	600	3,0	600	12 15	10.4	П6

[10] Серия МС4ТКПКТМ (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145x85x55 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162x156x64 мм

[11] Серия МС6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

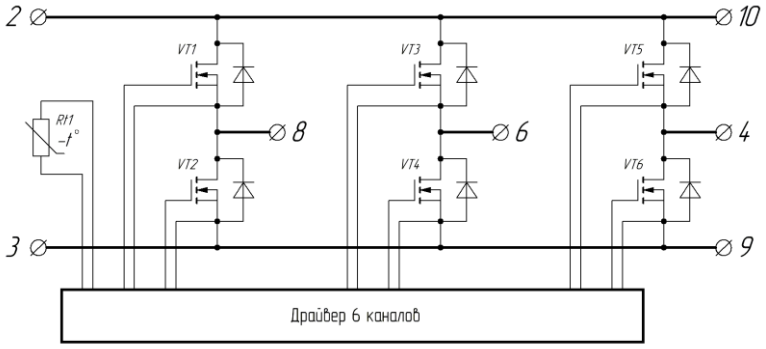


Рис 11.1
Серия МС6ТКПК
корпус П5

Модуль силовой
шестиключевой с драйвером управления
и контролем температуры

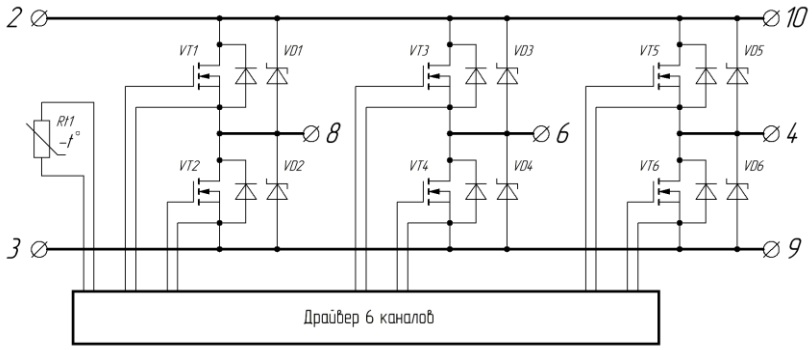


Рис 11.2
Серия МС6ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой
шестиключевой с параллельным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

[11] Серия МС6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

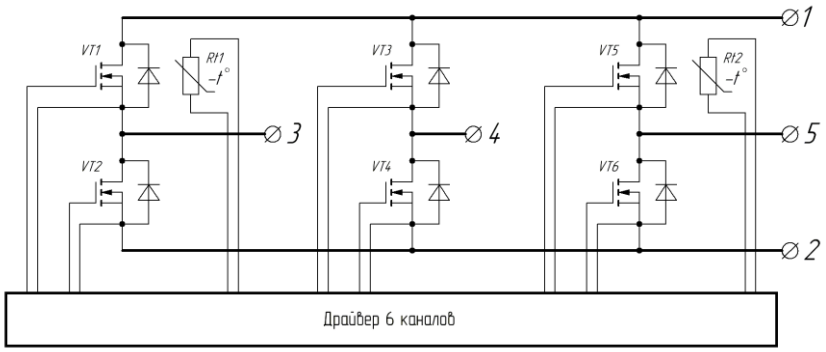


Рис 11.3
Серия МС6ТКПК
корпус П6

Модуль силовой
шестиключевой с драйвером управления
и контролем температуры

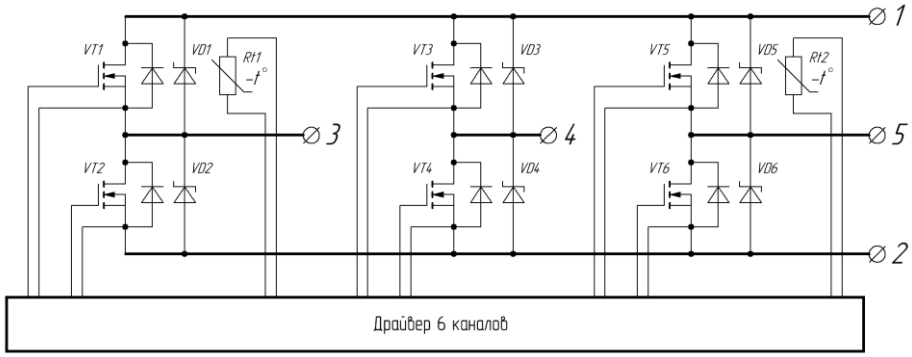


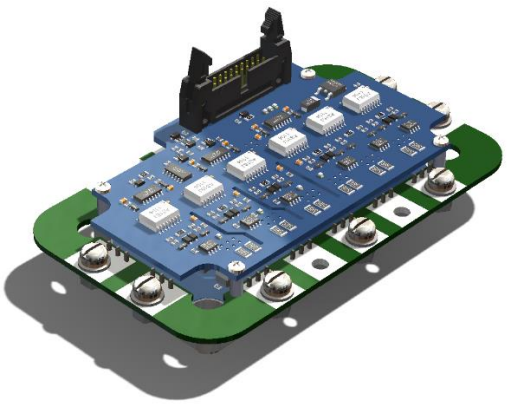
Рис 11.4
Серия МС6ТКПКШ
корпус П6

Модуль силовой
шестиключевой с параллельным диодом Шоттки,
драйвером управления и контролем температуры

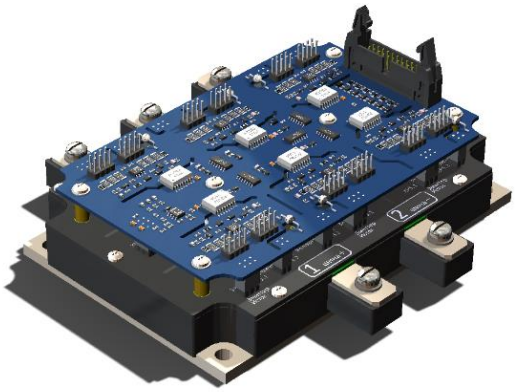
[11] Серия МС6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор МОП (MOSFET) SiC			Диод Шоттки SiC	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС6ТКПК (Ш) шестиключевой (диод Шоттки) с драйвером управления							
корпус П5							
МС6ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС6ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	11.1	П5
МС6ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС6ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	11.2	П5
МС6ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС6ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	11.1	П5
МС6ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС6ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	11.2	П5
МС6ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС6ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	11.1	П5
корпус П6							
МС6ТКПК-300-12-К1-П6-А1 МС6ТКПК-300-12-К1-П6-Б1	1200	300	6,0	–	12 15	11.3	П6
МС6ТКПКШ-300-12-К1-П5-А1 МС6ТКПКШ-300-12-К1-П5-Б1	1200	300	6,0	300	12 15	11.4	П6
МС6ТКПК-400-12-К1-П6-А1 МС6ТКПК-400-12-К1-П6-Б1	1200	400	4,5	–	12 15	11.3	П6
МС6ТКПКШ-400-12-К1-П5-А1 МС6ТКПКШ-400-12-К1-П5-Б1	1200	400	4,5	400	12 15	11.4	П6
МС6ТКПК-500-12-К1-П6-А1 МС6ТКПК-500-12-К1-П6-Б1	1200	500/400	3,6	–	12 15	11.3	П6
МС6ТКПКШ-500-12-К1-П5-А1 МС6ТКПКШ-500-12-К1-П5-Б1	1200	500/400	3,6	500/400	12 15	11.4	П6

Серия МС6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм



Корпус **П6**
габаритные размеры:
162х156х64 мм

[12] Серия МС4Д4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

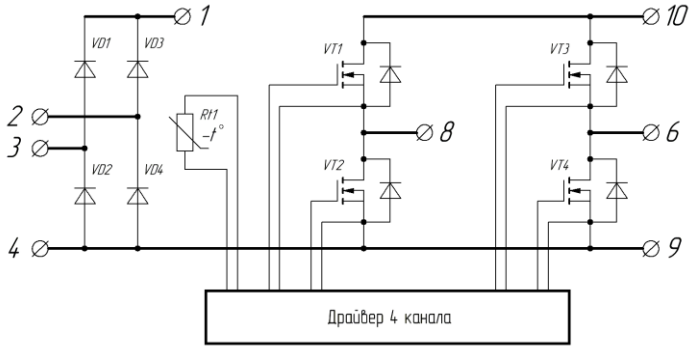


Рис 12.1
Серия МС4Д4ТКПК
корпус П5

Модуль силовой четырехключевой
с диодным мостом (БВД), встроенным драйвером управления
и контролем температуры

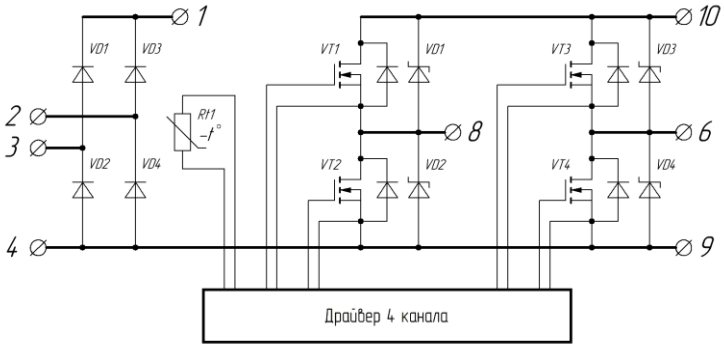


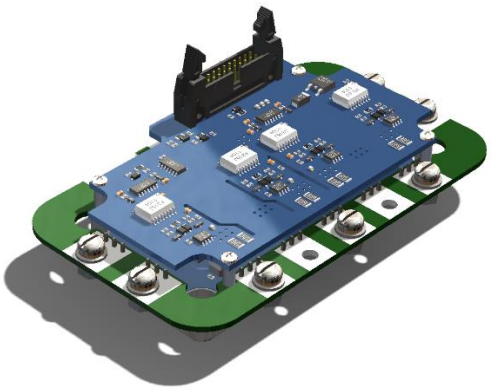
Рис 12.2
Серия МС4Д4ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой четырехключевой
с параллельным диодом Шоттки, диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[12] Серия МС4Д4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4Д4ТКПК (Ш) четырехключевой (диод Шоттки) с диодным мостом и драйвером управления							
корпус П5							
МС4Д4ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС4Д4ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	12.1	П5
МС4Д4ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС4Д4ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	12.2	П5
МС4Д4ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС4Д4ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	12.1	П5
МС4Д4ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС4Д4ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	12.2	П5
МС4Д4ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС4Д4ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	12.1	П5

Серия МС4Д4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[13] Серия МС4ДР4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

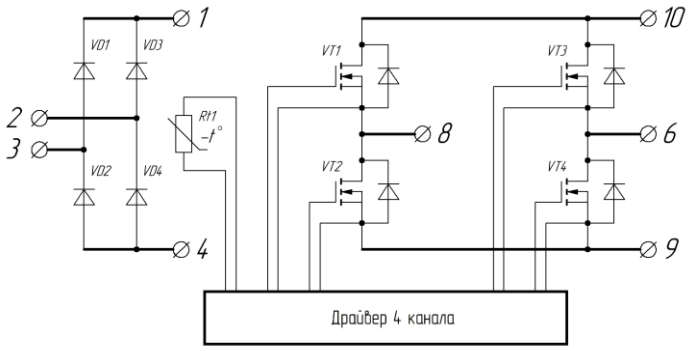


Рис 13.1
Серия МС4ДР4ТКПК
корпус П5

Модуль силовой четырехключевой
с раздельным диодным мостом (БВД), встроенным драйвером управления
и контролем температуры

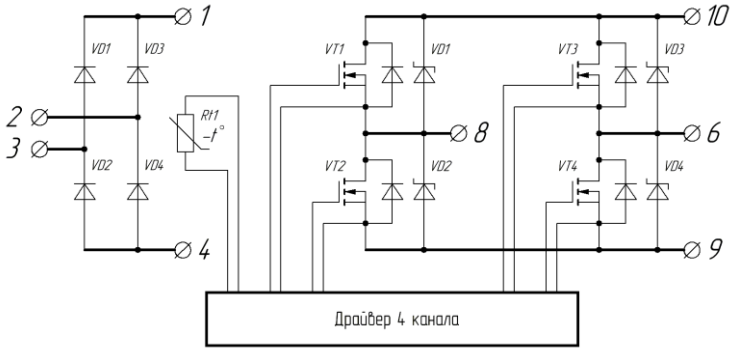


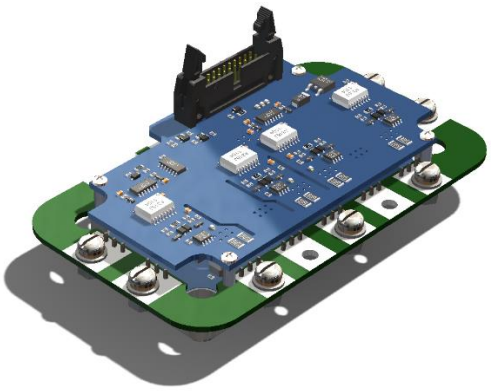
Рис 13.2
Серия МС4ДР4ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой четырехключевой
с раздельным диодным мостом (БВД), параллельным диодом Шоттки,
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[13] Серия МС4ДР4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4ДР4ТКПК (Ш) четырехключевой (диод Шоттки) с разд. диодным мостом и драйвером упр.							
корпус П5							
МС4ДР4ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС4ДР4ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	13.1	П5
МС4ДР4ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС4ДР4ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	13.2	П5
МС4ДР4ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС4ДР4ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	13.1	П5
МС4ДР4ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС4ДР4ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	13.2	П5
МС4ДР4ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС4ДР4ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	13.1	П5

Серия МС4ДР4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[14] Серия МС4Д6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

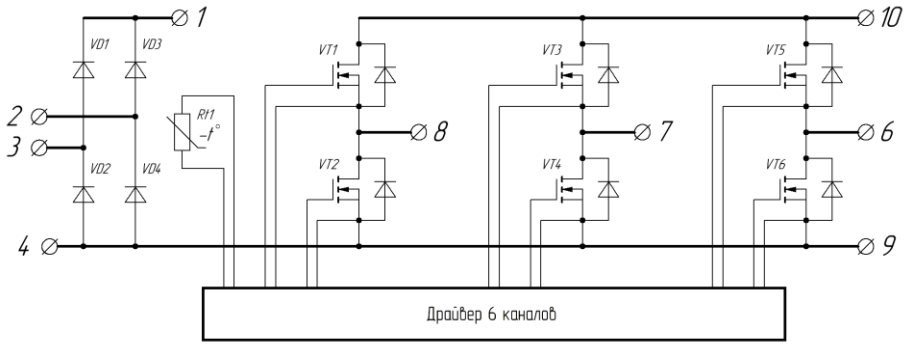


Рис 14.1
Серия МС4Д6ТКПК
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с диодным мостом (БВД), встроенным драйвером управления
и контролем температуры

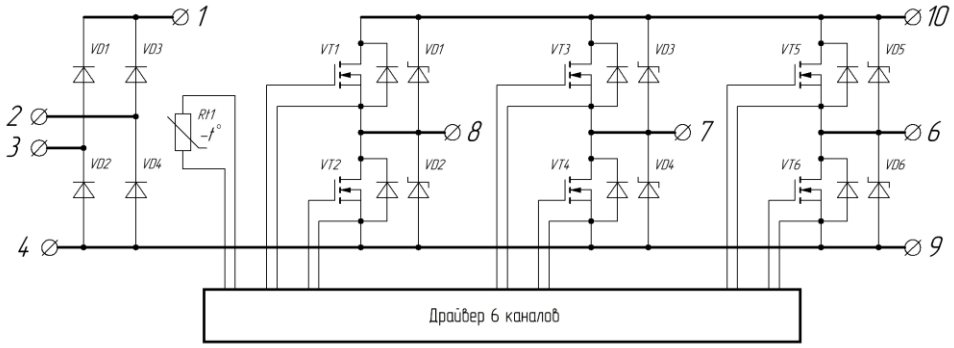


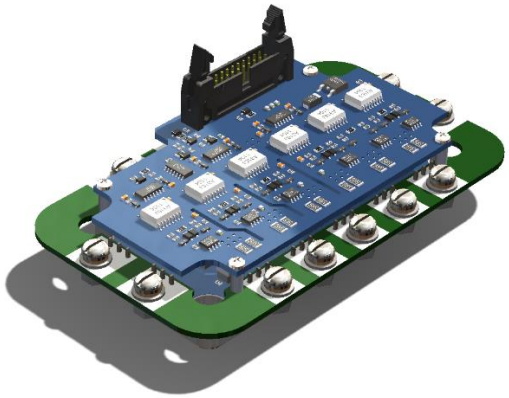
Рис 14.2
Серия МС4Д6ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с параллельным диодом Шоттки, диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[14] Серия МС4Д6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4Д6ТКПК (Ш) шестиключевой (диод Шоттки) с диодным мостом и драйвером управления							
корпус П5							
МС4Д6ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС4Д6ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	14.1	П5
МС4Д6ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС4Д6ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	14.2	П5
МС4Д6ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС4Д6ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	14.1	П5
МС4Д6ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС4Д6ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	14.2	П5
МС4Д6ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС4Д6ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	14.1	П5

Серия МС4Д6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[15] Серия МС4ДР6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

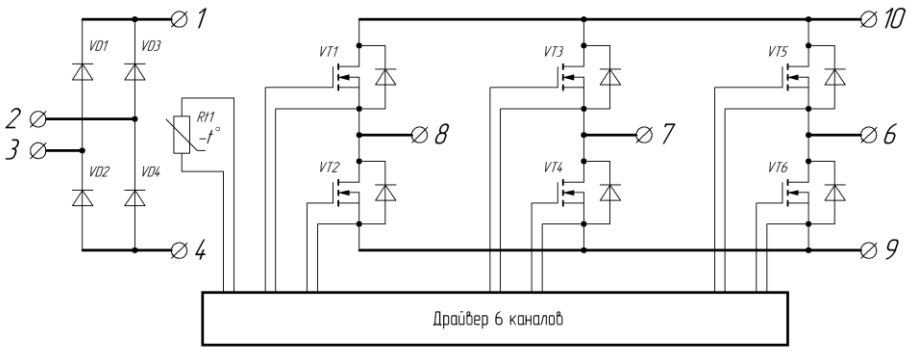


Рис 15.1
Серия МС4ДР6ТКПК
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с раздельным диодным мостом (БВД), встроенным драйвером управления
и контролем температуры

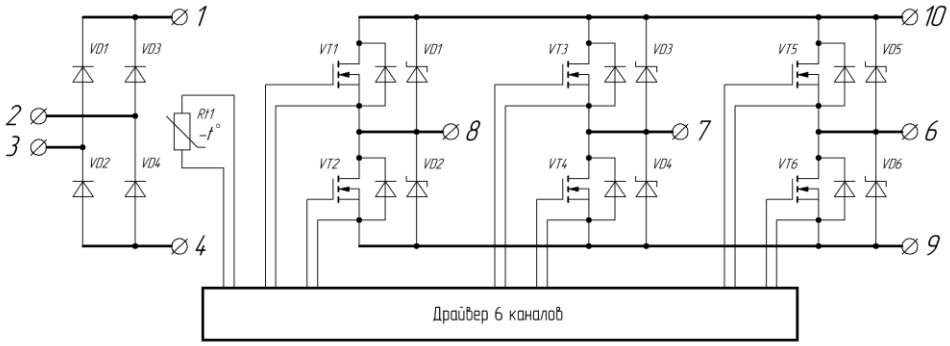


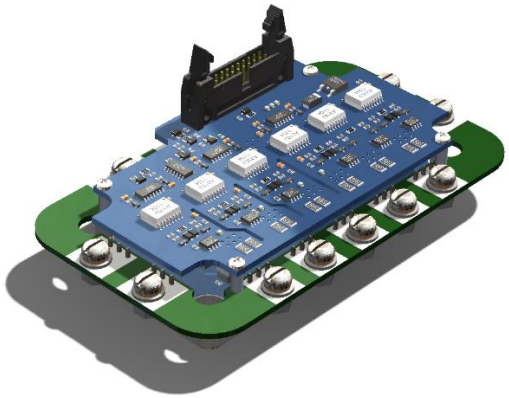
Рис 15.2
Серия МС4ДР6ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с параллельным диодом Шоттки, раздельным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[15] Серия МС4ДР6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС4ДР6ТКПК (Ш) шестиключевой (диод Шоттки) с разд. диодным мостом и драйвером упр.							
корпус П5							
МС4ДР6ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС4ДР6ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	15.1	П5
МС4ДР6ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС4ДР6ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	15.2	П5
МС4ДР6ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС4ДР6ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	15.1	П5
МС4ДР6ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС4ДР6ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	15.2	П5
МС4ДР6ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС4ДР6ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	15.1	П5

Серия МС4ДР6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[16] Серия МС6Д4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

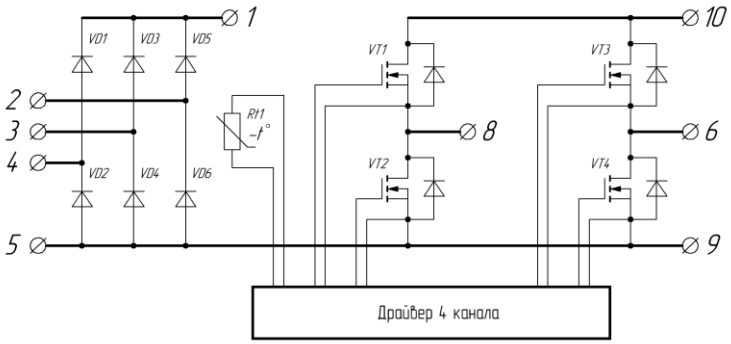


Рис 16.1
Серия МС6Д4ТКПК
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с трехфазным диодным мостом (БВД), встроенным драйвером управления
и контролем температуры

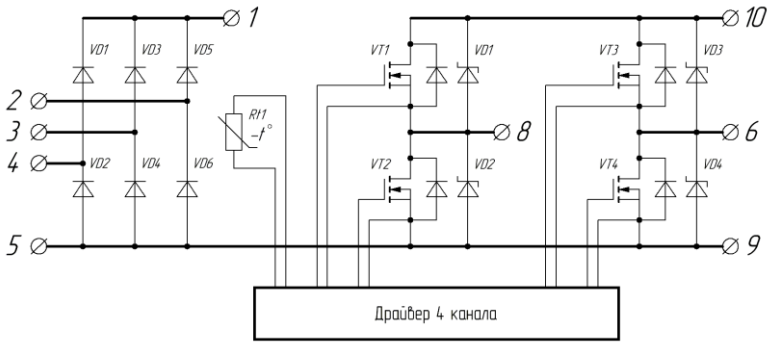


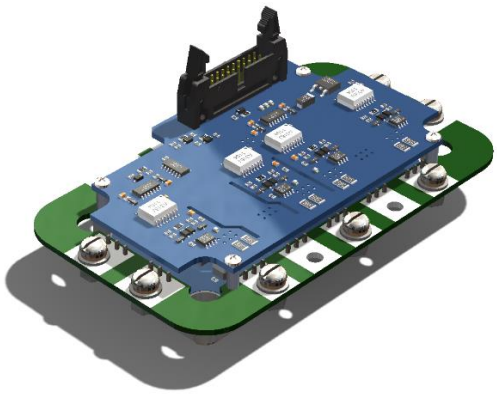
Рис 16.2
Серия МС6Д4ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с параллельным диодом Шоттки, трехфазным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[16] Серия МС6Д4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС6Д4ТКПК (Ш) шестиключевой (диод Шоттки) с трехфазным мостом и драйвером управления							
корпус П5							
МС6Д4ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС6Д4ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	16.1	П5
МС6Д4ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС6Д4ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	16.2	П5
МС6Д4ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС6Д4ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	16.1	П5
МС6Д4ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС6Д4ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	16.2	П5
МС6Д4ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС6Д4ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	16.1	П5

Серия МС6Д4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[17] Серия МС6ДР4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

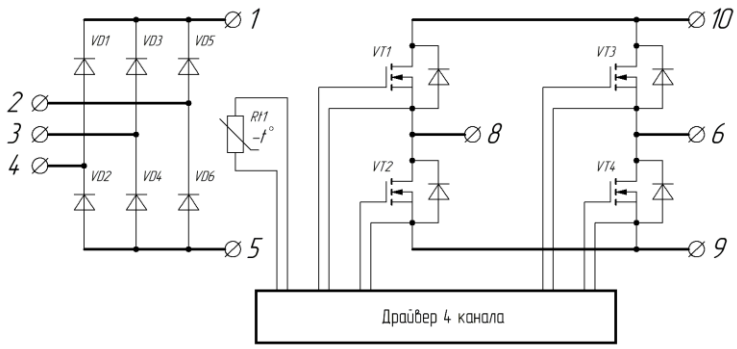


Рис 17.1
Серия МС6ДР4ТКПК
корпус П5

Модуль силовой четырехключевой
с трехфазным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

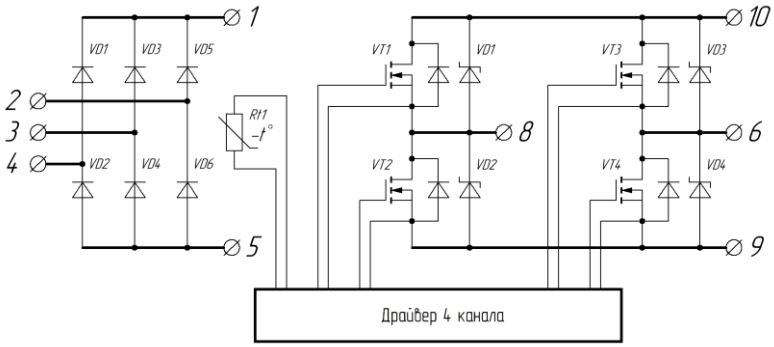


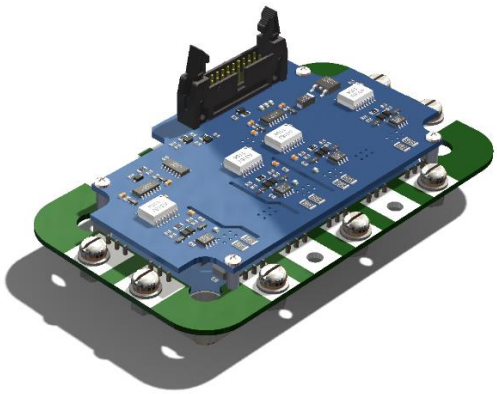
Рис 17.2
Серия МС6ДР4ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой четырехключевой
с параллельным диодом Шоттки, трехфазным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[17] Серия МС6ДР4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС6ДР4ТКПК (Ш) четырехключевой (диод Шоттки) с разд. трехфазным мостом и драйвером упр.							
корпус П5							
МС6ДР4ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС6ДР4ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	17.1	П5
МС6ДР4ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС6ДР4ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	17.2	П5
МС6ДР4ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС6ДР4ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	17.1	П5
МС6ДР4ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС6ДР4ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	17.2	П5
МС6ДР4ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС6ДР4ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	17.1	П5

Серия МС6ДР4ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[18] Серия МС6Д6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

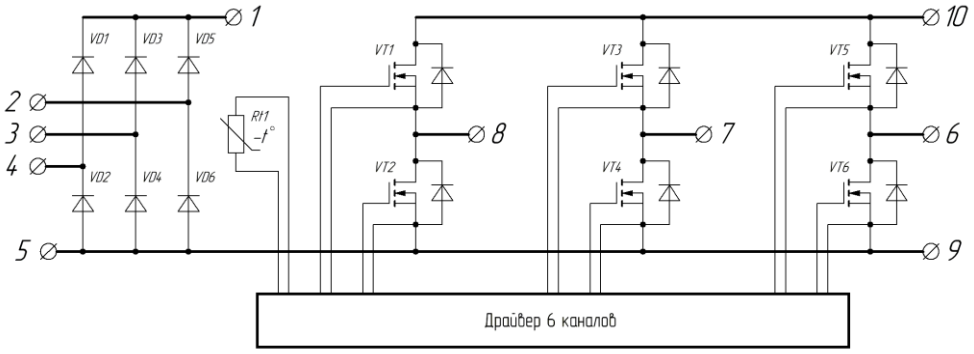


Рис 18.1
Серия МС6Д6ТКПК
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с трехфазным диодным мостом (БВД), встроенным драйвером управления
и контролем температуры

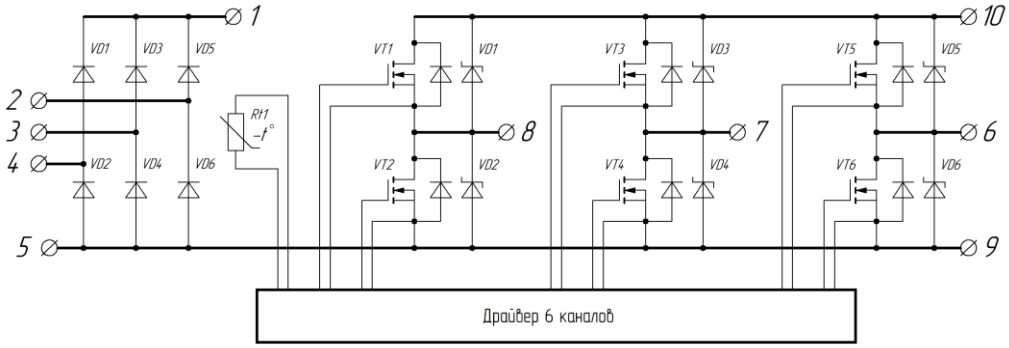


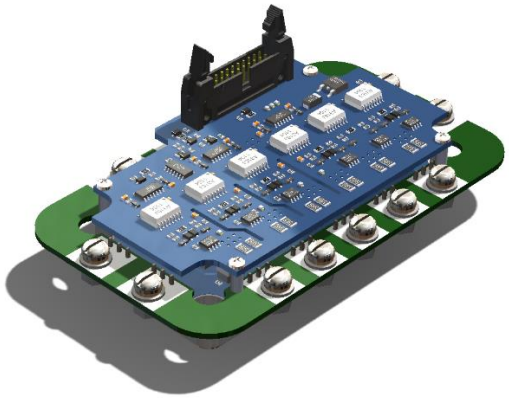
Рис 18.2
Серия МС6Д6ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с параллельным диодом Шоттки, трехфазным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[18] Серия МС6Д6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС6Д6ТКПК (Ш) шестиключевой (диод Шоттки) с трехфазным мостом и драйвером управления							
корпус П5							
МС6Д6ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС6Д6ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	18.1	П5
МС6Д6ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС6Д6ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	18.2	П5
МС6Д6ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС6Д6ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	18.1	П5
МС6Д6ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС6Д6ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	18.2	П5
МС6Д6ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС6Д6ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	18.1	П5

Серия МС6Д6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид



Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

[19] Серия МС6ДР6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET схемы принципиальные

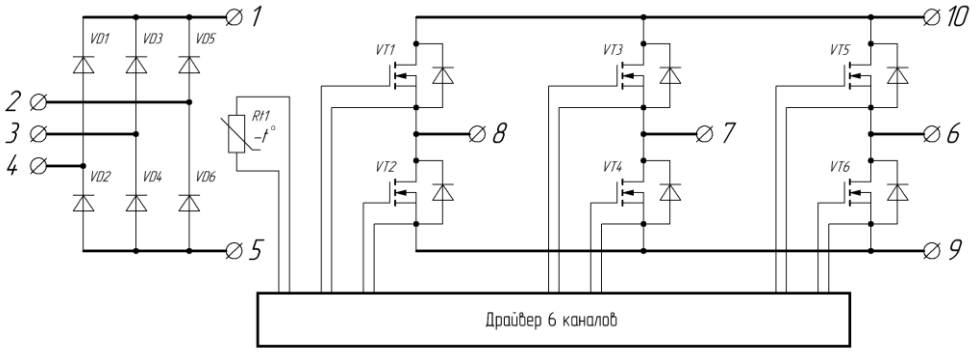


Рис 19.1
Серия МС6ДР6ТКПК
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с раздельным трехфазным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

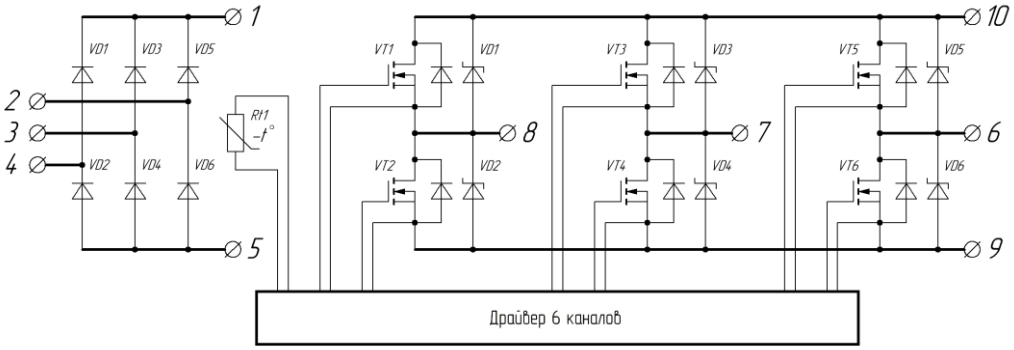


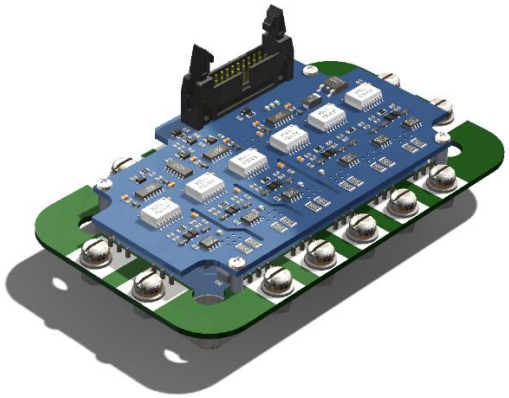
Рис 19.2
Серия МС6ДР6ТКПКШ
корпус П5

Модуль силовой шестиключевой
с параллельным диодом Шоттки, раздельным трехфазным диодным мостом (БВД),
встроенным драйвером управления и контролем температуры

[19] Серия МС6ДР6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET перечень 1200 В

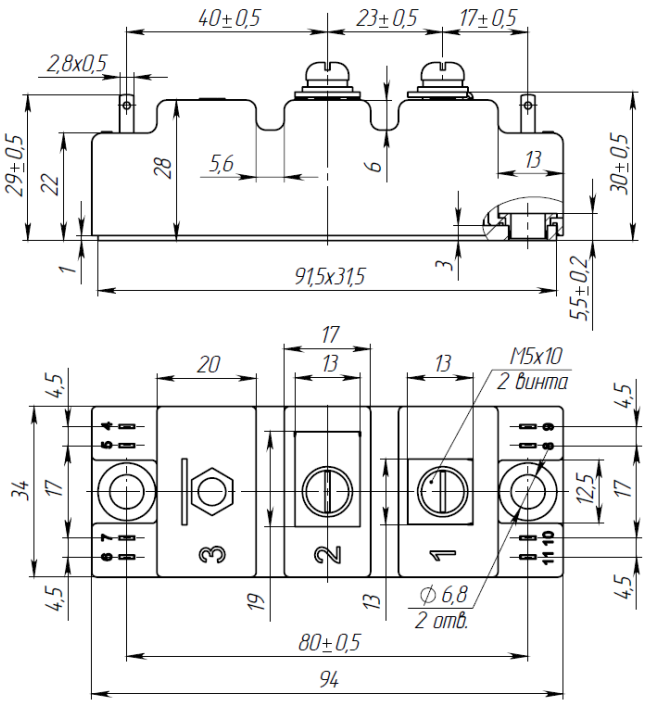
Наименование	Основные характеристики					Схема	Корпус
	Транзистор **МОП (MOSFET) SiC**			Диод **Шоттки SiC**	Драйвер		
	$U_{СИ\ макс}$	$I_{С\ макс}$ / $I_{корп}$	$R_{СИ\ отк}$	$I_{пр\ Д\ макс}$/ $I_{корп}$	$U_{\ пит\ др.}$		
	В	А	мОм	А	В		
МС6ДР6ТКПК (Ш) шестиключевой (диод Шоттки) с разд. трехфазным мостом и драйвером упр.							
корпус П5							
МС6ДР6ТКПК-100-12-К1-П5-А1 МС6ДР6ТКПК-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	–	12 15	19.1	П5
МС6ДР6ТКПКШ-100-12-К1-П5-А1 МС6ДР6ТКПКШ-100-12-К1-П5-Б1	1200	100	18	100	12 15	19.2	П5
МС6ДР6ТКПК-200-12-К1-П5-А1 МС6ДР6ТКПК-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	–	12 15	19.1	П5
МС6ДР6ТКПКШ-200-12-К1-П5-А1 МС6ДР6ТКПКШ-200-12-К1-П5-Б1	1200	200/100	9,0	200/100	12 15	19.2	П5
МС6ДР6ТКПК-300-12-К1-П5-А1 МС6ДР6ТКПК-300-12-К1-П5-Б1	1200	300/100	6,0	–	12 15	19.1	П5

Серия МС6ДР6ТКПК (Ш), модули SiC MOSFET корпуса внешний вид

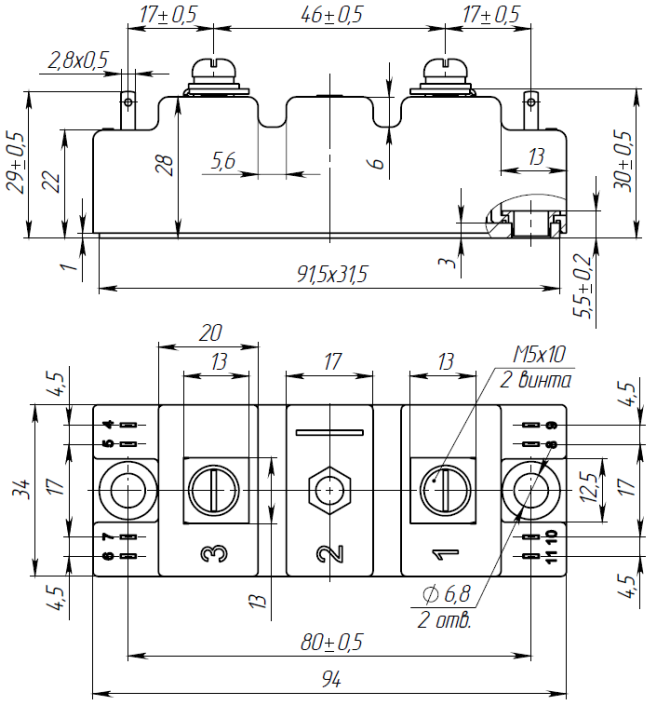


Корпус **П5**
габаритные размеры:
145х85х55 мм

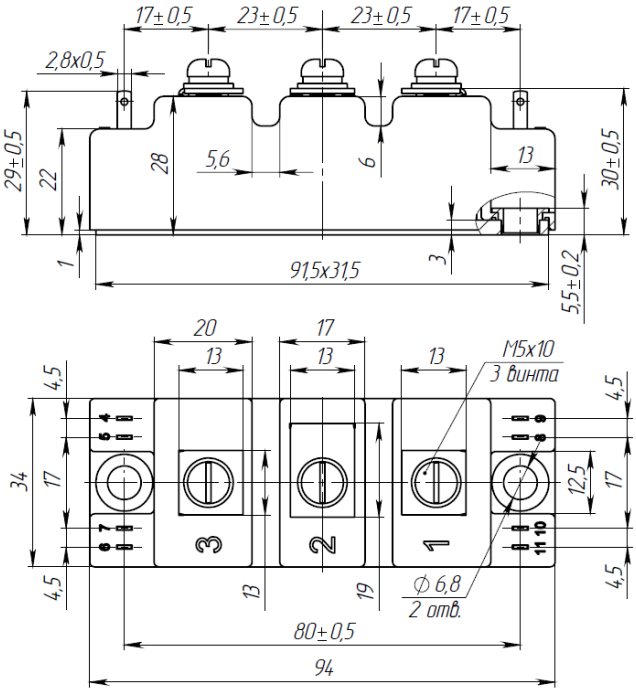
Габаритные и присоединительные размеры



Корпус **П1**
МСТКПК

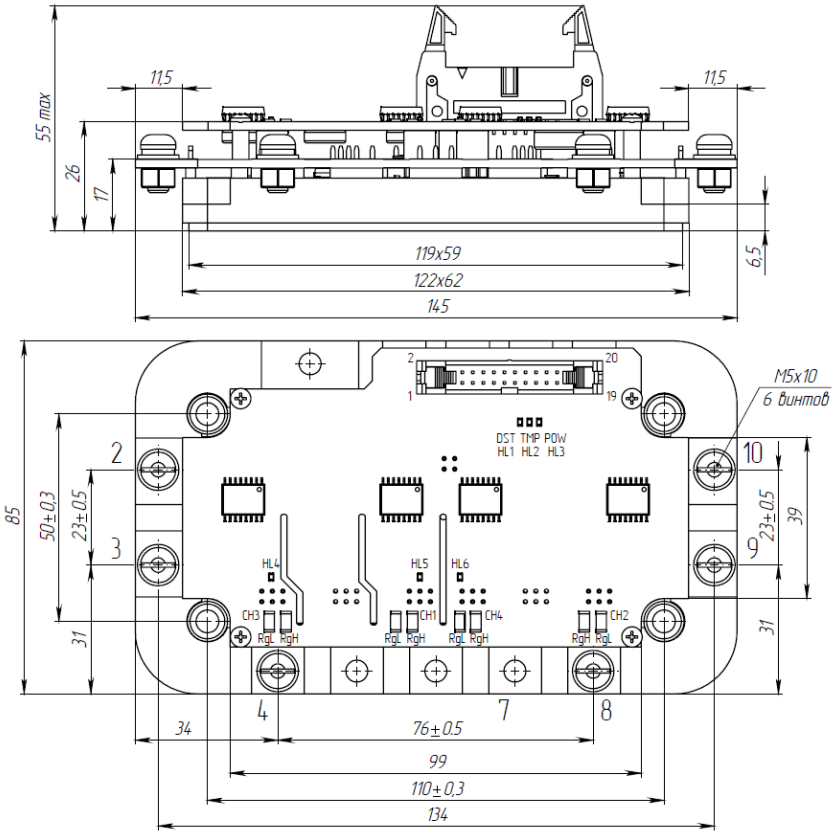


Корпус **П1**
МСПТКПК

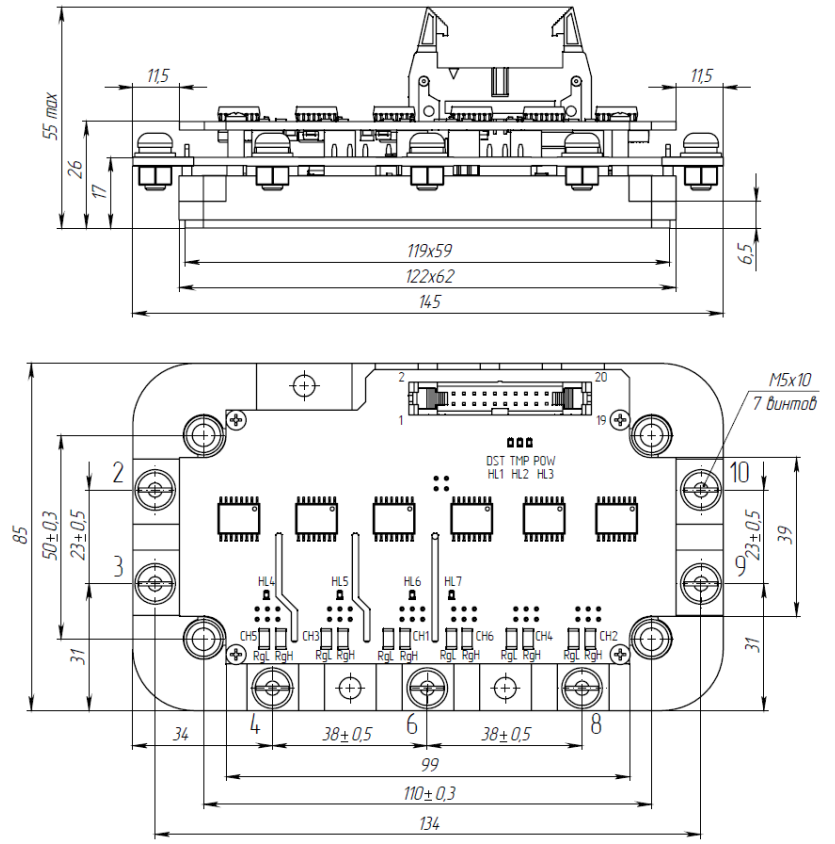


Корпус **П1**
МС2ТКПК

Габаритные и присоединительные размеры

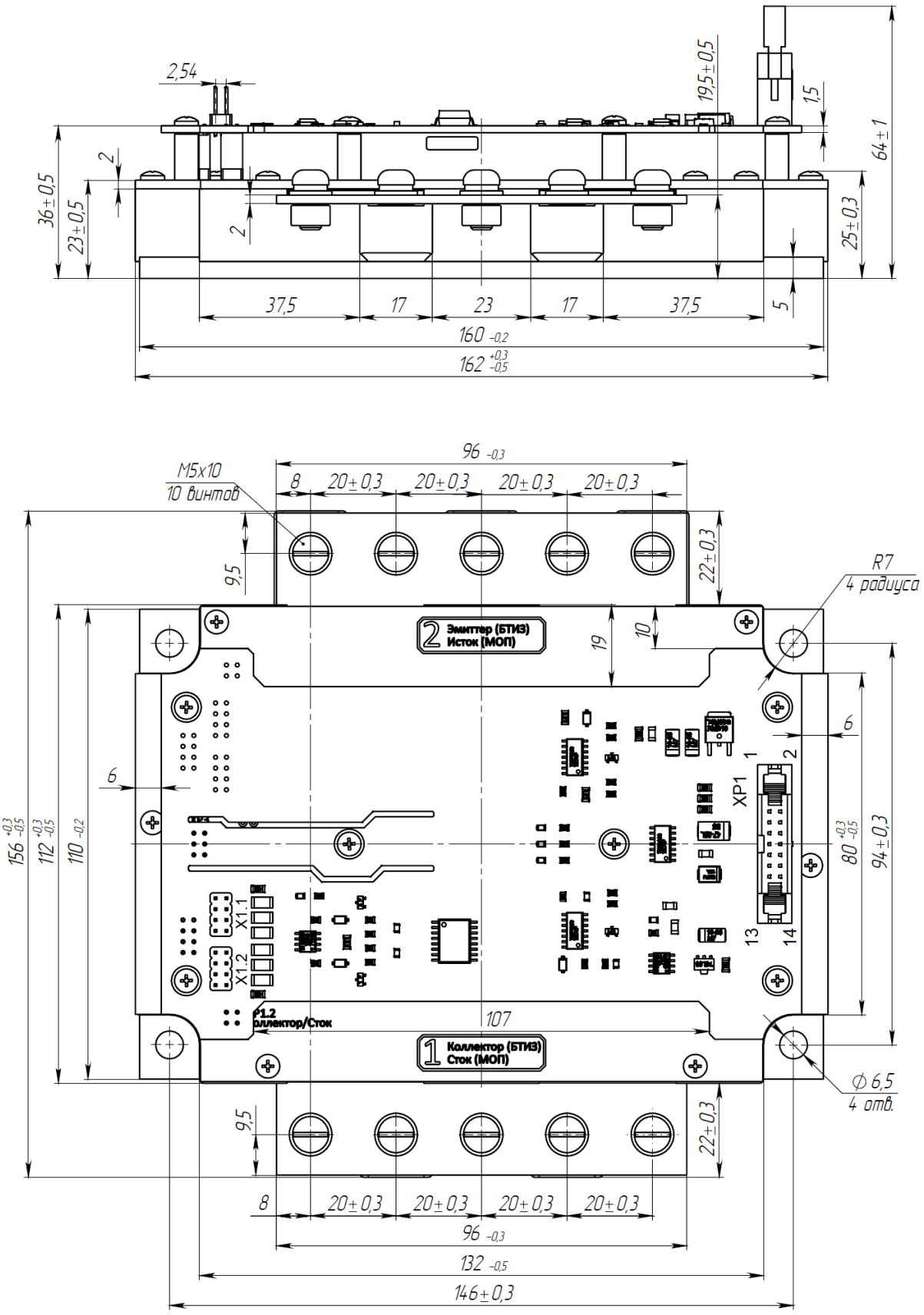


Корпус **П5**
МС4ТКПК



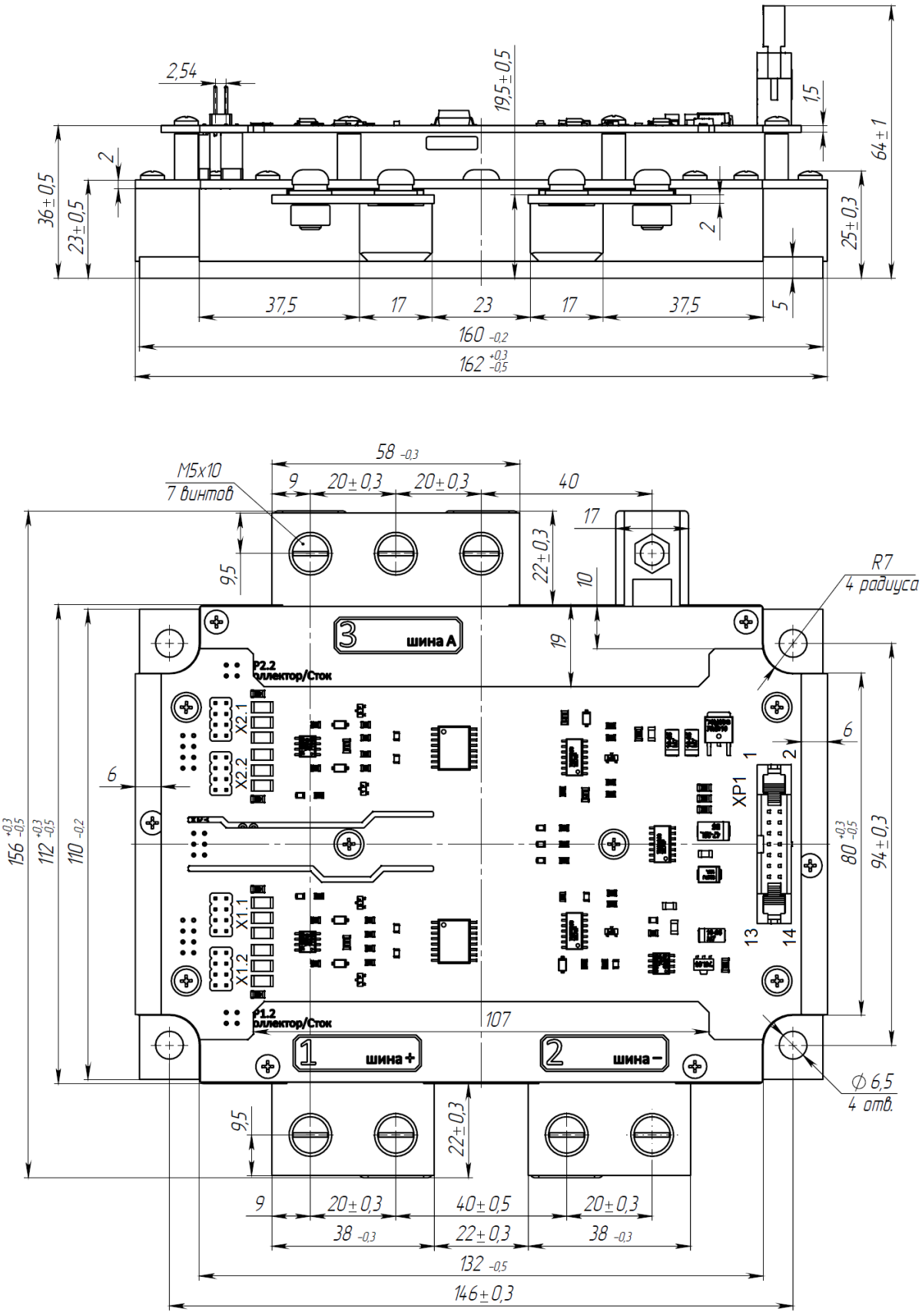
Корпус **П5**
МС6ТКПК

Габаритные и присоединительные размеры



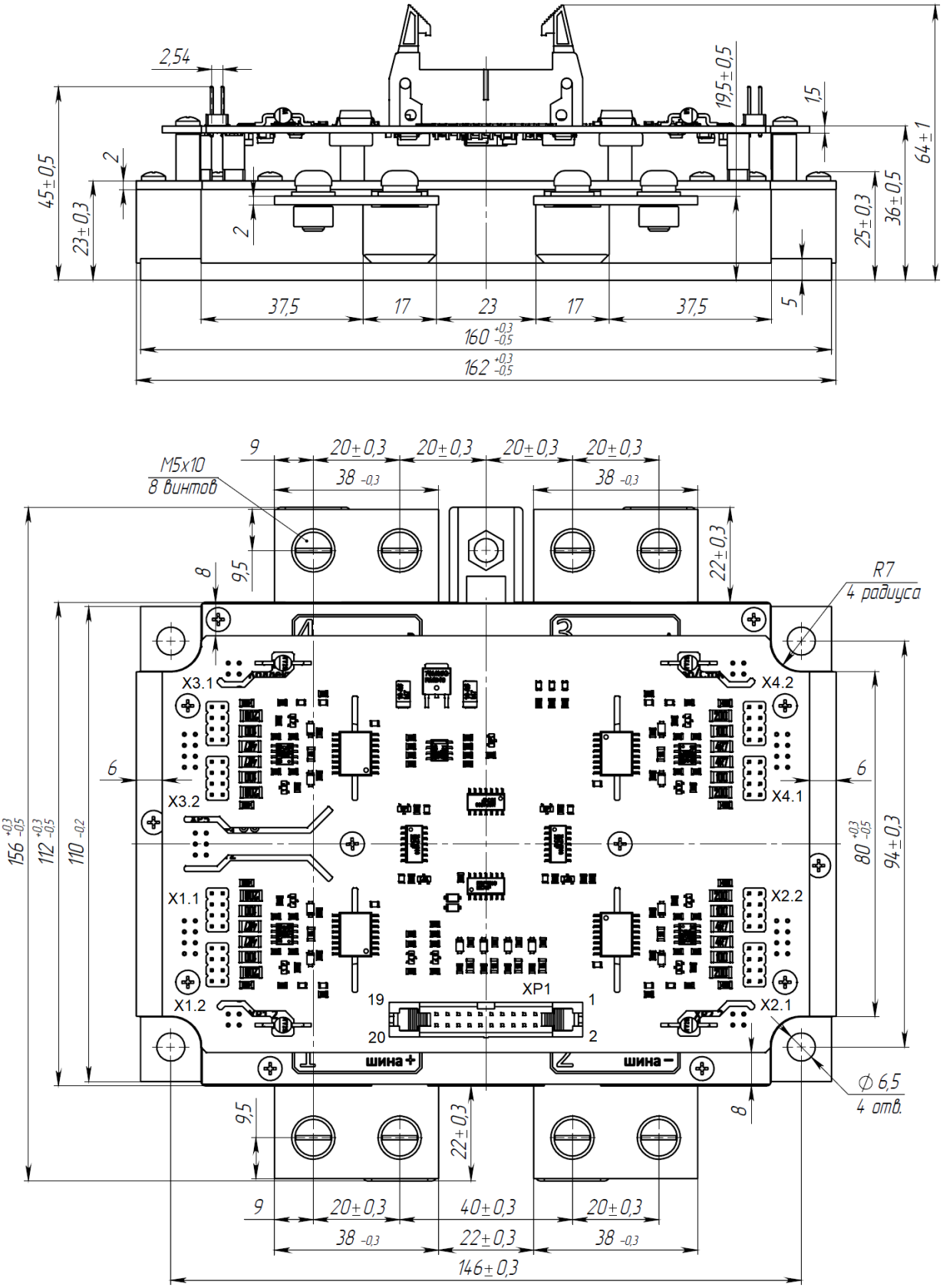
Корпус **П6**
МСТКПК

Габаритные и присоединительные размеры



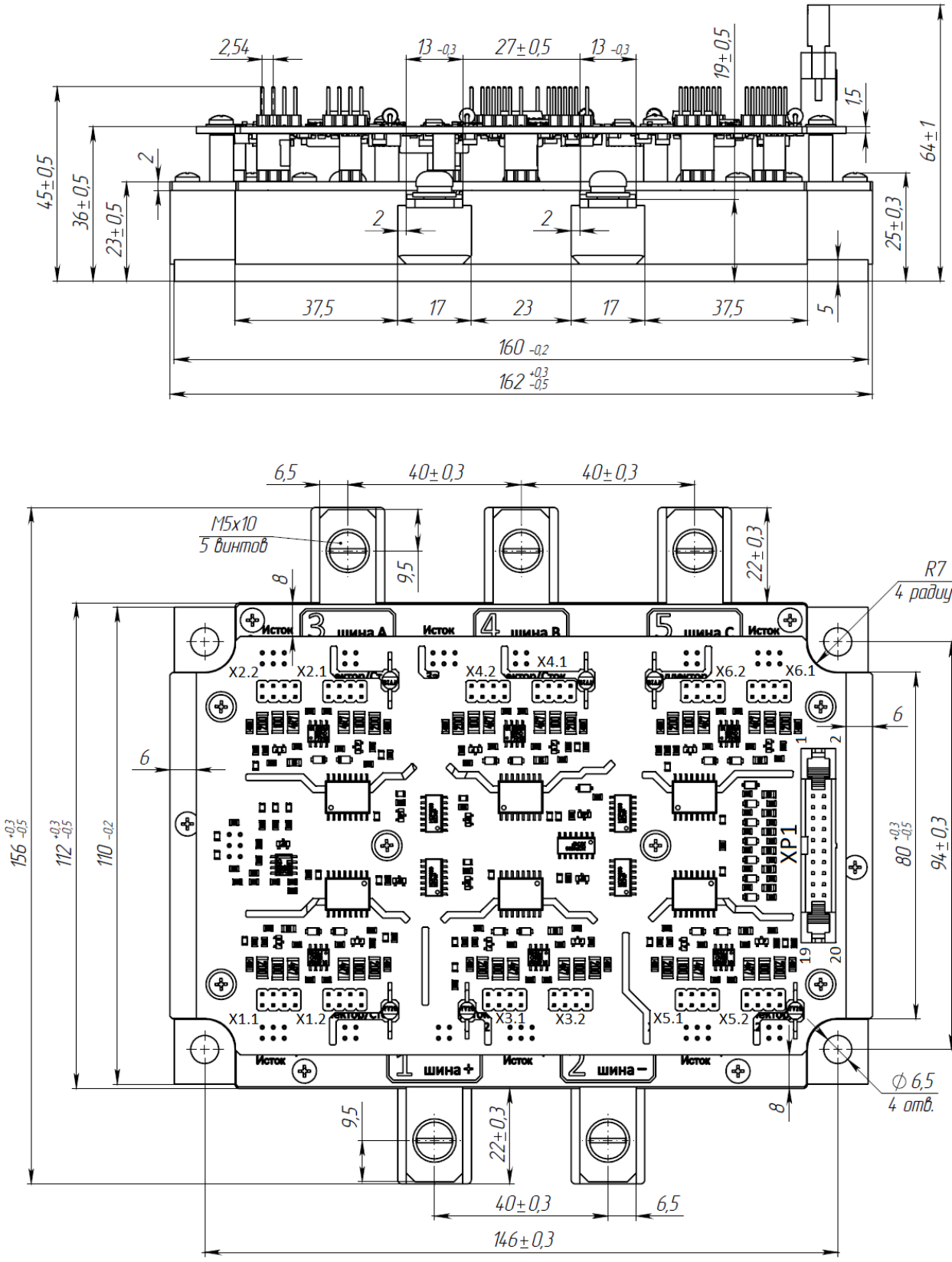
Корпус **П6**
МС2ТКПК

Габаритные и присоединительные размеры



Корпус **П6**
МС4ТКПК

Габаритные и присоединительные размеры



Корпус **П6**
МС6ТКПК